

етный указатель

ние

Персоналии	1513
Обзоры	1513
Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40)	1513
Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px)	1514
Структура, механические и термические свойства (PACS 60)	1514
Структура, кристаллография (PACS 61)	1514
1. Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16)	1515
2. Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43)	1515
3. Кластеры и наночастицы (PACS 61.46)	1515
4. Дефекты в кристаллах (PACS 61.72)	1516
5. Физические эффекты, связанные с облучением. Радиационные дефекты (PACS 61.80)	1516
Механические и акустические свойства (PACS 62). Динамика решетки (PACS 63)	1517
Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64)	1517
Термические свойства (PACS 65). Диффузия и теплопроводность (PACS 66)	1517
Структура поверхностей, границ раздела тонких пленок (PACS 68)	1518
Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70)	1519
Электронные состояния (PACS 71)	1519
1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)	1519
Транспортные явления (PACS 72)	1520
1. Явления электронной проводимости в полупроводниках (PACS 72.20)	1521
2. Высокочастотные эффекты и эффекты обусловленные плазмой (PACS 72.30)	1521
3. Фотопроводимость и фотогальванический эффект (PACS 72.40)	1521
Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)	1522
1. Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20)	1523
2. Барьеры Шоттки (PACS 73.30)	1524
3. Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40)	1524
4. Транспортные явления в тонких пленках (PACS 73.50)	1526
Сверхпроводимость (PACS 74). Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76)	1526
Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства (PACS 77)	1527
Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)	1527
1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)	1528

5.6.2. Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30)	1529
5.6.3. Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)	1529
5.6.4. Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т.п.) (PACS 78.66)	1531
5.7. Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79)	1531
6. Физика полупроводниковых приборов (PACS 84; 85)	1532
7. Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур (PACS 81; 85)	1533

1. Персоналии

Захарий Фишелевич Красильник (к 60-летию со дня рождения)	4	503
Владимир Иванович Иванов-Омский (к 75-летию со дня рождения)	4	505
Владимир Иделевич Перель (К 80-летию со дня рождения).	8	897
О Владимире Иделевиче Переле. Ю.Н. Демков	8	898
Памяти Людмилы Германовны Лаврентьевой.	9	1150

2. Обзоры

Возможности и основные принципы управления пластической релаксацией плёнок GeSi/Si и Ge/Si ступенчато изменяемого состава. Ю.Б. Болховитанов, А.К. Гутаковский, А.С. Дерябин, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов	1	3
Примесные резонансные состояния в полупроводниках. В.Я. Алешкин, Л.В. Гавриленко, М.А. Одноблудов, И.Н. Ясневич	8	899

3. Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40)

Влияние процесса плавления на акустический отклик соединений CdTe и GaAs при импульсном лазерном облучении. А. Байдуллаева, В.П. Велешук, А.И. Власенко, Б.К. Даулетмуратов, О.В. Ляшенко, П.Е. Мозоль	3	286
Эффективная генерация первой волноводной моды в гетеролазере InGaAs/GaAs/InGaP. А.А. Бирюков, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин, В.Я. Алёшкин, А.А. Дубинов, В.В. Кочаровский, Вл.В. Кочаровский	3	361
Динамика формирования фотоответа в детекторной структуре из арсенида галлия. ГИ. Айзенштат, М.А. Лелеков, О.П. Толбанов	4	451
Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. I. Теория, оптические свойства материалов. Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов	7	864

Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. II. Анализ гетероструктур на различных подложках. Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов	7	871
Мощные лазерные диоды с длиной волны излучения 835 нм на основе различных типов лазерных гетероструктур. А.В. Мурашова, Д.А. Винокуров, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, В.В. Шамахов, В.В. Васильева, В.А. Капитонов, А.Ю. Лешко, А.В. Лютецкий, Т.А. Налет, Д.Н. Николаев, А.Л. Станкевич, Н.В. Фетисова, И.С. Тарасов, Y.S. Kim, D.H. Kang, C.Y. Lee	7	882
Residual resistance and Joule heat generation in bulk samples and nanostructures. V. L. Gurevich	8	931
Edge effects in propagation of terahertz radiation in subwavelength periodic structures. B. Gelmont, R. Parthasarathy, T. Globus	8	940
Цикличность сверхбыстрой автомодуляции спектра поглощения света, возникающей при накачке и стимулированном излучении в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневой, А.Н. Кривонос, Т.А. Налет	9	1053
Влияние уровня возбуждения на оптические свойства микродиска GaAs—AlGaO с активной областью на основе квантовых точек InAs. А.М. Надточий, С.А. Блохин, А.В. Сахаров, М.М. Кулагина, Ю.М. Задиранов, Н.Ю. Гордеев, М.В. Максимов, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов, Е. Шток, Т. Варминг, Д. Бимберг	10	1247
Свойства волноводных мод в фотонном кристалле на основе щелевого кремния с дефектом. А.С. Спицын, Г.Ф. Глинский	10	1256
Структурные и энергетические характеристики собственных дефектов вакансионного типа в двуоснонапряженной решетке GaN. Т.В. Безъязычная, В.М. Зеленковский, А.Л. Гурский, Г.И. Рябцев	11	1281
Быстрые оптические регистрирующие среды на полупроводниковых наноструктурах для записи и обработки изображений. П.Г. Кашерининов, А.А. Томасов	11	1391
Субтерагерцовые автоколебания в сверхбыстрой автомодуляции поглощения света в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневой, А.Н. Кривонос	12	1426
3.1. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px)		
Вклад оже-рекомбинации в насыщение ватт-амперных характеристик мощных полупроводниковых лазеров ($\lambda = 1.0-1.9$ мкм). А.В. Лютецкий, К.С. Борщёв, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов	1	106
Оптические параметры диодных лазеров на основе InAsSb/InAsSbP-гетероструктуры. А.П. Астахова, Т.В. Безъязычная, Л.И. Буров, А.С. Горбачев, А.Г. Рябцев, Г.И. Рябцев, М.А. Щемелев, Ю.П. Яковлев	2	228
Мощные лазерные диоды с длиной волны излучения 808 нм на основе различных типов асимметричных гетероструктур со сверхшироким волноводом. В.В. Безотосный, В.В. Васильева, Д.А. Винокуров, В.А. Капитонов, О.Н. Крохин, А.Ю. Лешко, А.В. Лютецкий, А.В. Мурашова, Т.А. Налет, Д.Н. Николаев, Н.А. Пихтин, Ю.М. Попов, С.О. Слипченко, А.Л. Станкевич, Н.В. Фетисова, В.В. Шамахов, И.С. Тарасов	3	357

Эффективная генерация первой волноводной моды в гетеролазере InGaAs/GaAs/InGaP. А.А. Бирюков, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин, В.Я. Алёшкин, А.А. Дубинов, В.В. Кочаровский, В.В. Кочаровский	3	361
Нелинейно-оптическое преобразование частоты в двухцветном лазере с вертикальным внешним резонатором. Ю.А. Морозов, И.С. Нефедов, Т. Leinonen, М.Ю. Морозов	4	478
Пороговые характеристики ИК-лазера на основе глубоких квантовых ям InAsSb/AlSb. Л.В. Данилов, Г.Г. Зегря	5	573
Каскадный лазер на мелких допорах в δ -легированных сверхрешетках GaAs/AlGaAs. Н.А. Бекин, В.Н. Шагин	5	621
Концентрация и температура носителей заряда в квантовых ямах лазерных гетероструктур в режимах спонтанного и стимулированного излучения. Л.Е. Воробьев, В.Л. Зерова, К.С. Борщёв, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов, G. Belenky	6	711
Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaAsN/InGaAsN на подложках GaAs. В.В. Мамутин, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, В.С. Михрин, А.М. Надточий, Е.В. Пирогов	7	811
Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. I. Теория, оптические свойства материалов. Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов	7	811
Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. II. Анализ гетероструктур на различных подложках. Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов	7	811
Мощные лазерные диоды с длиной волны излучения 835 нм на основе различных типов лазерных гетероструктур. А.В. Мурашова, Д.А. Винокуров, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, В.В. Шамахов, В.В. Васильева, В.А. Капитонов, А.Ю. Лешко, А.В. Лютецкий, Т.А. Налет, Д.Н. Николаев, А.Л. Станкевич, Н.В. Фетисова, И.С. Тарасов, Y.S. Kim, D.H. Kang, C.Y. Lee	7	811
Эффективный полупроводниковый лазер зеленого диапазона с электроннолучевой накачкой на основе многослойных наноструктур A ^{IV} B ^{VI} . М.М. Зверев, Н.А. Гамов, Е.В. Жданова, Д.В. Перегудов, В.Б. Студенов, И.В. Седова, С.В. Гронин, С.В. Сорokin, С.В. Иванов, П.С. Копьев	12	1247

4. Структура, механические и термические свойства (PACS 60)

4.1. Структура, кристаллография (PACS 61)

Высокотемпературные матрицы детекторов ядерного излучения на основе 4H-SiC ионно-легированных $p^+ - n$ -переходов. Е.В. Калинина, Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, А.А. Ситникова, А.В. Садохин, А.Ю. Азаров, В.Г. Коссов, Р.Р. Яфаев	1	106
Влияние электронного облучения на скорость удаления носителей в кремнии и карбиде кремния модификации 4H. В.В. Козловский, В.В. Емцев, К.В. Емцев, Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, В.Н. Ломасов, Г.А. Оганесян, А.А. Лебедев	2	228

ние облучения электронами и протонами на характеристики поверхностно-барьерных структур С-детекторов ядерных излучений. А.М. Иванов, Б. Строкан, В.В. Козловский, А.А. Лебедев	3	370
ности оптических и фотоэлектрических свойств специально легированных и легированных Си монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, П. Мирончук, Л.В. Булатецкая, А.Г. Кевшин	4	399
исследование самоорганизации неупорядоченных материалов с применением теории информации. А.А. Авачева, Н.В. Бодягин, С.П. Вихров, М. Мурсалов	5	513
е как пассивирующий слой в гетероструктуре Te/HgCdTe. И.С. Вирт, И.В. Курило, И.А. Рудый, Ф. Сизов, Н.Н. Михайлов, Р.Н. Смирнов	7	788
влияние кислорода на структуру и электронные свойства нанокластеров кремния Si _n (n = 5, 6, 10, 18). А. Гниденко, В.Г. Заводинский	7	817
исследование характеристик оксидных пленок гадолиния, титана и эрбия на поверхности n-6H-SiC под воздействием сверхвысокочастотной обработки. Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, В.В. Миленин, Б. Охрименко, А.М. Светличный, В.В. Поляков	7	888
исследование пространственной симметрии возбужденных состояний в полупроводниках A ^{III} B ^V в Г-точке. Д. Дымников, О.В. Константинов	8	934
особенности использования широкозонных полупроводниковых материалов в задачах регистрации ультрафиолетового излучения. А.М. Иванов, Н.Б. Строкан, А. Лебедев	9	1135
особенности влияния электронной и нейтронной радиации на фотоэлектрические свойства специально легированных и легированных Си монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, В. Булатецкая	10	1263
фотоэлектрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников InSe и GaSe при облучении электронами с энергией 12.5 МэВ. З.Д. Ковалюк, О.А. Политанская, Н. Сидор, В.Т. Маслюк	11	1321
оптический спектр носителей заряда в Ag ₂ Te. А. Алиев, З.Ф. Агаев, Р.И. Селим-заде	12	1415
вопросу радиационной стойкости SiC при чередовании стадий облучения и отжига. А.М. Иванов, Б. Строкан, А.А. Лебедев	12	1466

6. Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16)

исследование монокристаллов тройного соединения In ₃ Se ₅ . И.В. Боднар	9	1046
стаи и параметры доменов, образующихся в результате синодального распада четверных твердых растворов в эпитаксиальных гетероструктурах GaInP/Ga _{1-x} In _{1-x} As _{1-y} P _{1-y} /GaInP/GaAs(001). П. Домашевская, Н.Н. Гордиенко, Н.А. Румянцова, В. Середин, Б.Л. Агапов, Л.А. Битюцкая, Н. Арсентьев, Л.С. Вавилова, И.С. Тарасов	9	1086
структурно-физические и структурные свойства двусторонне δ-легированных PHEMT-гетероструктур на основе AlGaAs/InGaAs/AlGaAs. И.С. Васильевский, С. Галиев, Е.А. Климов, В.Г. Мокеров, С.С. Широков, Р.М. Имамов, И.А. Субботин	9	1102

4.1.2. Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43)

Некоторые аспекты подбора примесей, улучшающих фотоэлектрические характеристики халькогенидных стеклообразных полупроводников. И.И. Бурдиян, В.В. Косюк, Р.А. Пынзрь	2	208
Нанокластеры платины, инкапсулированные в аморфный углерод. Т.К. Звонарева, А.А. Ситникова, Г.С. Фролова, В.И. Иванов-Омский	3	331
Влияние температуры и интенсивности освещения на образование метастабильных состояний в a-Si:Н. И.А. Курова, Н.Н. Ормонт	4	447
Исследование самоорганизации неупорядоченных материалов с применением теории информации. Т.Г. Авачева, Н.В. Бодягин, С.П. Вихров, С.М. Мурсалов	5	513
Исследование свойств поверхности арсенида галлия методом сканирующей атомно-силовой микроскопии. В.Г. Божков, Н.А. Торхов, И.В. Ивонин, В.А. Новиков	5	546
Электроннографическое исследование параметров ближнего порядка в аморфных пленках Yb _{1-x} Sm _x As ₂ S ₄ . Э.Ш. Гаджиев, А.И. Мададзаде	5	608
Термическая неустойчивость фуллеренов кремния, стабилизируемых водородом. Компьютерный эксперимент. А.Е. Галашев	5	611
Колебательная спектроскопия аморфного углерода, модифицированного Pt. В.И. Иванов-Омский, Т.К. Звонарева, Г.С. Фролова	9	1131
Свойства и структура стекол (As ₂ Se ₃) _{1-x} (SnSe ₂) _x (Te ₂ Se) _x и (As ₂ Se ₃) _{1-x} (SnSe) _x (Te ₂ Se) _x . Г.А. Бордовский, А.В. Марченко, Е.И. Теруков, П.П. Серегин, Т.В. Лиходеева	11	1353
Особенности световых вольт-амперных характеристик p-i-n-структур на аморфном кремнии при туннельно-дрейфовом механизме переноса темнового тока. А.А. Андреев	11	1363

4.1.3. Кластеры и наночастицы (PACS 61.46)

Вариация края поглощения света в пленках SiN _x с кластерами кремния. М.Д. Ефремов, В.А. Володин, Д.В. Марин, С.А. Аржанникова, Г.Н. Камаев, С.А. Кочубей, А.А. Попов	2	202
Нанокластеры платины, инкапсулированные в аморфный углерод. Т.К. Звонарева, А.А. Ситникова, Г.С. Фролова, В.И. Иванов-Омский	3	331
Латеральное упорядочение нановискерсов GaAs на поверхностях GaAs(111)В и GaAs(110) при молекулярно-пучковой эпитаксии. Г.Э. Цырлин, Н.В. Сибирев, С. Sartel, J.-C. Harmand	6	726
Формирование SiO _x -слоев при плазменном распылении Si- и SiO ₂ -мишеней. А.Н. Карпов, Д.В. Марин, В.А. Володин, J. Jedrzejewski, Г.А. Качурин, Е. Savir, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая, Y. Goldstein, I. Balberg	6	747
Влияние кислорода на структуру и электронные свойства нанокластеров кремния Si _n (n = 5, 6, 10, 18). А.А. Гниденко, В.Г. Заводинский	7	817

Фотопроцессы в нанокристаллах GeSi/Si, формирующихся в процессе сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в среде германа. Д.О. Филатов, М.В. Круглова, М.А. Исаков, С.В. Сипрова, М.О. Марычев, В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, С.А. Денисов	9	1116	Процессы возбуждения ионов Er^{3+} в SiO_2 с нанокристаллами Si. А.А. Прокофьев, А.С. Москаленко, И.Н. Яснеевич	8	985
Влияние интенсивности торможения ионов на дефектообразование при имплантации в нанокристаллы кремния. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, Д.В. Марин, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, В.А. Володин	9	1145	Релаксационные процессы в проводимости кристаллов $Cd_{1-x}Mn_xTe$ ($0.02 < x < 0.55$). Е.С. Никонюк, З.И. Захарук, М.И. Кучма, В.Л. Шляховый, А.И. Раренко, И.Н. Юрийчук	9	1028
О зависимости высоты нитевидных нанокристаллов GaAs от скорости осаждения. Н.В. Сибирев, В.Г. Дубровский, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, Ю.Б. Самсоненко, В.М. Устинов	11	1286	Влияние интенсивности торможения ионов на дефектообразование при имплантации в нанокристаллы кремния. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, Д.В. Марин, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, В.А. Володин	9	1145
4.1.4. Дефекты в кристаллах (PACS 61.72)			О параметрах образования вакансий в кристаллах подгруппы углерода. М.Н. Магомедов	10	1153
Возможности и основные принципы управления пластической релаксацией пленок GeSi/Si и Ge/Si ступенчато изменяемого состава. Ю.Б. Болховитянов, А.К. Гутаковский, А.С. Дерябин, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов	1	3	Проявление в функции Гоффмана особенностей генерационно-рекомбинационных свойств бистабильных дефектов в полупроводниках. А.Г. Никитина, В.В. Зуев	10	1190
Зависимость изгиба зон на границе микроконтакта AgBr—AgI от формы и размера гетерогенной системы. А.В. Ханефт, А.С. Поплавной, Б.А. Сечкарев, Л.В. Сотникова	1	40	Расчет электрической емкости самокомпенсированных полупроводников с межцентровыми прыжками одного и двух электронов (на примере кремния с радиационными дефектами). Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, А.Г. Забродский	12	1420
Бистабильные амфотерные центры в полупроводнике. А.Г. Никитина, В.В. Зуев	2	141	Электрические свойства гетерозитаксиальных слоев HgCdTe <i>n</i> -типа проводимости, модифицированных ионным травлением. М. Поляск, И.И. Ижнин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.С. Варавин, К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский	12	1444
Ионизация в электрическом поле <i>DX</i> -центра, связанного с серой, в $In_{1-x}Ga_xP$. Ю.К. Крутоголов	2	171	Рост слитков карбида кремния политипа 4H на затравках с плоскостью $(10\bar{1}0)$. Д.Д. Авров, А.В. Булатов, С.И. Дорожкин, А.О. Лебедев, Ю.М. Таиров	12	1483
Действие мощных нано- и фемтосекундных лазерных импульсов на кремниевые наноструктуры. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, В.А. Володин, Д.В. Марин, М. Deutschmann	2	181	4.1.5. Физические эффекты, связанные с облучением. Радиационные дефекты (PACS 61.80)		
Моделирование приповерхностной протон-индуцированной диффузии бора в кремнии. О.В. Александров, В.В. Козловский	3	262	Электрофизические свойства облученного протонами $CdSnAs_2$. В.Н. Брудный, Т.В. Ведерникова	1	
Определение энергии и концентрации амфотерных дефектов методом дифференциальной обработки температурной зависимости концентрации свободных носителей. А.Г. Никитина, В.В. Зуев	4	389	Высокотемпературные матрицы детекторов ядерного излучения на основе 4H-SiC ионно-легированных $p^+ - n$ -переходов. Е.В. Калинин, Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, А.А. Ситникова, А.В. Садохин, А.Ю. Азаров, В.Г. Коссов, Р.Р. Яфаев	1	
Особенности оптических и фотоэлектрических свойств специально не легированных и легированных Си монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук, Л.В. Булатецкая, А.Г. Кевшин	4	399	Бистабильные амфотерные центры в полупроводнике. А.Г. Никитина, В.В. Зуев	2	141
Исследование зависимости электрофизических параметров пленок $Cd_xHg_{1-x}Te$, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, от уровня легирования индием. В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Д.Г. Икусов, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, Г.Ю. Сидоров, М.В. Якушев	6	664	Исследование проводимости сверхтонких пленок бифталоцианина олова. Н.Л. Левшин, Н.Н. Пронин, П.А. Форш, С.Г. Юдин	2	141
Исследование влияния температуры крекинга мышьяка на эффективность его встраивания в пленки $CdHgTe$ в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии. Г.Ю. Сидоров, Н.Н. Михайлов, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Ю.Г. Сидоров, С.А. Дворецкий	6	668	Влияние электронного облучения на скорость удаления носителей в кремнии и карбиде кремния модификации 4H. В.В. Козловский, В.В. Емцев, К.В. Емцев, Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, В.Н. Ломасов, Г.А. Оганесян, А.А. Лебедев	2	2
Кинетика формирования различных типов водородсодержащих доноров в кремнии, имплантированном протонами. Ю.М. Покотило, А.Н. Петух, О.А. Дзичковский	7	893	Влияние процесса плавления на акустический отклик соединений CdTe и GaAs при импульсном лазерном облучении. А. Байдуллаева, В.П. Велешук, А.И. Власенко, Б.К. Даулетмуратов, О.В. Ляшенко, П.Е. Мозоль	3	2

Влияние облучения электронами и протонами на характеристики поверхности-барьерных структур С-детекторов ядерных излучений. А.М. Иванов, Л.Б. Строкан, В.В. Козловский, А.А. Лебедев	3	370
Особенности оптических и фотоэлектрических свойств специально не легированных и легированных Si монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л. Мирончук, Л.В. Булатецкая, А.Г. Кевшин	4	399
Кинетика формирования различных типов водородоудержающих доноров в кремнии, имплантированном протонами. Ю.М. Покотило, А.Н. Петух, О.А. Дзичковский	7	893
Особенности использования широкозонных полупроводящих материалов в задачах регистрации ядерного излучения. А.М. Иванов, Н.Б. Строкан, А.А. Лебедев	9	1135
Влияние интенсивности торможения ионов на дефектообразование при имплантации в нанокристаллы кремния. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, Д.В. Марин, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, В.А. Володин	9	1145
Управление в функции Гоффмана особенностями генерационно-рекомбинационных свойств бистабильных дефектов в полупроводниках. А.Г. Никитина, В.В. Зуев	10	1190
Особенности влияния электронной и нейтронной радиации на фотоэлектрические свойства специально не легированных и легированных Si монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л.В. Булатецкая	10	1263
Фотоэлектрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников InSe и GaSe при облучении электронами с энергией 12.5 МэВ. З.Д. Ковалюк, О.А. Политанская, О.Н. Сидор, В.Т. Маслюк	11	1321
Фотоэлектрические свойства гетерозитаксиальных слоев HgCdTe n-типа проводимости, модифицированных ионным травлением. М. Поцяк, И.И. Ижнин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.С. Варавин, К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский	12	1444
Вопросу радиационной стойкости SiC при чередовании стадий облучения и отжига. А.М. Иванов, Н.Б. Строкан, А.А. Лебедев	12	1466

2. Механические и акустические свойства (PACS 62). Динамика решетки (PACS 63)

Некоторые аспекты подбора примесей, улучшающих фотоэлектрические характеристики халькогенидных стеклообразных полупроводников. И.И. Бурдиян, В.В. Косюк, Р.А. Пынзарь	2	208
Гибридно-фононные резонансы в квантовом канале. В.В. Карпунин, В.А. Маргулис	6	711
Релаксация возбужденных состояний доноров в кремнии с излучением междолинных фононов. В.В. Цыпленков, Е.В. Демидов, К.А. Ковалевский, В.Н. Шастин	9	1032
Инфракрасные спектры отражения многослойных эпитаксиальных гетероструктур с погруженными слоями InAs и GaAs. П.В. Середин, Э.П. Домашевская, А.Н. Лукин, И.Н. Арсентьев, Д.А. Винокуров, И.С. Тарасов	9	1072
Расчеты из первых принципов фононных спектров сверхрешеток $(GaP)_n(AIP)_m$. А.В. Кособуцкий, Е.Н. Малышева	10	1227

4.3. Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64)

Действие мощных нано- и фемтосекундных лазерных импульсов на кремниевые наноструктуры. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, В.А. Володин, Д.В. Марин, М. Deutschmann	2	181
Вариация края поглощения света в пленках SiN_x с кластерами кремния. М.Д. Ефремов, В.А. Володин, Д.В. Марин, С.А. Аржанникова, Г.Н. Камаев, С.А. Кочубей, А.А. Попов	2	202
Влияние флуктуаций на электронные и фононные процессы и термодинамические параметры Ag_2Te и Ag_2Se в области фазового перехода. С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев	4	404
Термическая неустойчивость фуллеренов кремния, стабилизируемых водородом. Компьютерный эксперимент. А.Е. Галашев	5	611
Состав и параметры доменов, образующихся в результате синодального распада четверных твердых растворов в эпитаксиальных гетероструктурах $GaInP/Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}/GaInP/GaAs(001)$. Э.П. Домашевская, Н.Н. Гордиенко, Н.А. Румянцева, П.В. Середин, Б.Л. Агалов, Л.А. Битюцкая, И.Н. Арсентьев, Л.С. Вавилова, И.С. Тарасов	9	1086
Энергетический спектр носителей заряда в Ag_2Te . С.А. Алиев, З.Ф. Агаев, Р.И. Селим-заде	12	1415

4.4. Термические свойства (PACS 65). Диффузия и теплопроводность (PACS 66)

Расщепление ника натрия на динамических вольтамперных характеристиках конвективных ионных токов структур металл-окисел-полупроводник. С.Г. Дмитриев, Ю.В. Маркин	1	45
Влияние оже-рекомбинации на тепловую стабильность мощных высоковольтных полупроводниковых диодов. Т.Т. Мнацаканов, М.Е. Левинштейн, А.С. Фрейдлин	2	220
Диффузия хрома в эпитаксиальный арсенид галлия. М.Д. Вилсова, Е.П. Другова, И.В. Пономарев, В.А. Чубирко	2	239
Моделирование приповерхностной протонно-стимулированной диффузии бора в кремнии. О.В. Александров, В.В. Козловский	3	262
Особенности проявления акцепторного состояния золота в кремнии с термодопорами. А.Д. Кирюхин, В.В. Григорьев, А.В. Зуев, В.В. Зуев	3	271
Влияние состояния вакансионного равновесия на процесс диффузии примеси хрома в арсениде галлия. С.С. Хлудков	3	378
Residual resistance and Joule heat generation in bulk samples and nanostructures. V. L. Gurevich	8	931
О параметрах образования вакансий в кристаллах подгруппы углерода. М.Н. Магомедов	10	1153
Энергетический спектр носителей заряда в Ag_2Te . С.А. Алиев, З.Ф. Агаев, Р.И. Селим-заде	12	1415
Электрические свойства гетерозитаксиальных слоев HgCdTe n-типа проводимости, модифицированных ионным травлением. М. Поцяк, И.И. Ижнин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.С. Варавин, К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский	12	1444

4.5. Структура поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 68)

Возможности и основные принципы управления пластической релаксацией пленок GeSi/Si и Ge/Si ступенчато изменяемого состава. Ю.Б. Болховитянов, А.К. Гутаковский, А.С. Дерябин, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов	1	3
<i>In situ</i> исследование кинетики формирования КТ InSb в матрице InAs(Sb). А.Н. Семенов, О.Г. Люблинская, В.А. Соловьев, Б.Я. Мельцер, С.В. Иванов	1	75
Сэндвич-структура InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников. Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин	1	101
Исследование проводимости сверхтонких пленок бифталоцианина олова. Н.Л. Левшин, Н.Н. Пронин, П.А. Форш, С.Г. Юдин	2	199
Некоторые аспекты подбора примесей, улучшающих фотоэлектрические характеристики халькогенидных стеклообразных полупроводников. И.И. Бурдиян, В.В. Косюк, Р.А. Пынзарь	2	208
Диффузия хрома в эпитаксиальный арсенид галлия. М.Д. Вилисова, Е.П. Другова, И.В. Пономарев, В.А. Чубирко	2	239
Фотолюминесценция с длиной волны до 1.6 мкм в квантовых точках с увеличенной эффективной толщиной слоя InAs. М.Н. Дроздов, Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.И. Шашкин	3	303
Влияние состояния вакансионного равновесия на процесс диффузии примеси хрома в арсениде галлия. С.С. Хлудков	3	378
Влияние флуктуаций на электронные и фононные процессы и термодинамические параметры Ag ₂ Te и Ag ₂ Se в области фазового перехода. С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев	4	404
Собственный окисел, возникающий на поверхности скола селенида галлия в результате длительного хранения. С.И. Драпак, С.В. Гаврилюк, З.Д. Ковалюк, О.С. Литвин	4	423
Кинетика резистивного отклика тонких пленок SnO _{2-x} в газовой среде. С.В. Рябцев, А.В. Юкиш, С.И. Ханго, Ю.А. Юраков, А.В. Шапошник, Э.П. Домашевская	4	491
Свойства пленок оксида цинка, синтезированных в низкотемпературном плазменном разряде в условиях бомбардировки компонентами плазмы. А.А. Сердобинцев, А.Г. Веселов, О.А. Кирясова	4	496
Исследование самоорганизации неупорядоченных материалов с применением теории информации. Т.Г. Авачева, Н.В. Бодягин, С.П. Вихров, С.М. Мурсалов	5	513
Сравнительный анализ механизмов формирования межфазной границы плечочной структуры в равновесных и резко неравновесных условиях. А.П. Беляев, В.П. Рубец, В.В. Антипов, Х.А. Тошходжаев	5	519
Исследование свойств поверхности арсенида галлия методом сканирующей атомно-силовой микроскопии. В.Г. Божков, Н.А. Торхов, И.В. Ивонин, В.А. Новиков	5	546

Критическая толщина перехода по Странскому-Красанову с учетом эффекта сегрегации. Д.В. Юрасов, Ю.Н. Дроздов	5	579
Рентгеноспектральный микроанализ полупроводниковых эпитаксиальных гетероструктур на основе моделирования транспорта электронов методом Монте-Карло. Т.Б. Попова, Л.А. Бакалейников, М.В. Заморянская, Е.Ю. Флегонтова	6	686
Латеральное упорядочение нановискероов GaAs на поверхностях GaAs(111)В и GaAs(110) при молекулярно-пучковой эпитаксии. Г.Э. Цырлин, Н.В. Сибирев, С. Sartel, J.-C. Harmand	6	726
Формирование сверхизлучения в наногетероструктурах с квантовыми точками. А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря	6	730
CdTe как пассивирующий слой в гетероструктуре CdTe/HgCdTe. И.С. Вирт, И.В. Курило, И.А. Рудый, Ф.Ф. Сизов, Н.Н. Михайлов, Р.Н. Смирнов	7	788
Изменение характеристик оксидных пленок гадолиния, титана и эрбия на поверхности n-6H-SiC под воздействием сверхвысокочастотной обработки. Ю.Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, В.В. Миленин, О.Б. Охрименко, А.М. Светличный, В.В. Поляков	7	888
Вызванные действием магнитного поля изменения примесного состава и микротвердости приповерхностных слоев кристаллов кремния. В.А. Макара, М.А. Васильев, Л.П. Стебленко, О.В. Коплак, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, С.Н. Науменко	9	1068
Адсорбция метилтиола на поверхности GaAs(100)-(2 × 4): квантово-химический анализ из первых принципов. М.В. Лебедев	9	1065
Фотолюминесценция нанокластеров GeSi/Si, формирующихся в процессе сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в среде германа. Д.О. Филатов, М.В. Круглова, М.А. Исаков, С.В. Сипрова, М.О. Марычев, В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, С.А. Денисов	9	1116
Роль флуктуаций потенциала в энергетической структуре квантовых ям GaAs/AlGaAs с А ⁺ -центрами. П.В. Петров, Ю.Л. Иванов, В.С. Михрин, А.Е. Жуков	10	1219
Расчеты из первых принципов фононных спектров сверхрешеток (GaP) _n (AlP) _m . А.В. Кособуцкий, Е.Н. Мальшева	10	1222
О зависимости высоты пикувидных нанокристаллов GaAs от скорости осаждения. Н.В. Сибирев, В.Г. Дубровский, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, Ю.Б. Самсоненко, В.М. Устинов	11	1286
Статические вольт-амперные характеристики туннельных МДП структур Au/CaF ₂ /n-Si(111). С.М. Сутурин, А.Г. Банщиков, Н.С. Соколов, С.Э. Тягинов, М.И. Векслер	11	1333
Квантово-размерные гетероструктуры на основе AlGaN для светодиодов глубокого ультрафиолетового диапазона, полученные методом субмонослойной дискретной молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота. В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, Т.В. Шубина, А.В. Сахаров, А.А. Ситникова, П.С. Копьев, С.В. Иванов, Е.В. Луценко, А.В. Данильчик, Н.В. Ржеуцкий, Г.П. Яблонский	12	1452

Эффективный полупроводниковый лазер зеленого диапазона с электрооптической накачкой на основе многослойных наноструктур $A^{IV}B^{VI}$. М.М. Зверев, Н.А. Гамов, Е.В. Жданова, Д.В. Перегудов, В.Б. Студенов, И.В. Седова, С.В. Гронин, С.В. Сорокин, С.В. Иванов, П.С. Копьев	12	1472
Особенности формирования нитевидных нанокристаллов GaAs на различных поверхностях кремния при молекулярно-пучковой эпитаксии. Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, В.П. Улин, В.Г. Дубровский	12	1478

5. Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70)

Лазерно-стимулированная модификация примесного энергетического спектра селенида галлия, интеркалированного кобальтом. И.И. Грыгорчак, А.И. Пелехович, Н.В. Вольтинская	4	385
--	---	-----

5.1. Электронные состояния (PACS 71)

Оптическая спектроскопия свободных экситонов в халькопиритном полупроводниковом соединении $CuInS_2$. А.В. Мудрый, А.В. Иванович, М.В. Якушев, Р. Мартин, А. Саад	1	31
Фазовый состав пленок системы Bi-S и формирование Bi_2S_3 с различной субструктурой. Г.М. Ахмедов	2	129
Роль фоновых примесей O и Cu в оптике кристаллов ZnSe с позиций теории пересекющихся зон. Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, Е.М. Гавришук, В.Г. Галстян	2	131
Оптические свойства твердых растворов $AgGa_xIn_{1-x}Se_2$. И.В. Боднар	2	153
Особенности проявления акцепторного состояния золота в кремнии с термодонорами. А.Д. Кирюхин, В.В. Григорьев, А.В. Зуев, В.В. Зуев	3	271
Лазерно-стимулированная модификация примесного энергетического спектра селенида галлия, интеркалированного кобальтом. И.И. Грыгорчак, А.И. Пелехович, Н.В. Вольтинская	4	385
Магнитная восприимчивость твердых растворов $Bi_2Te_3-Sb_2Te_3$. Н.П. Степанов, А.К. Гильфанов, Л.Д. Иванова, Ю.В. Гранаткина	4	410
Влияние температуры и интенсивности освещения на образование метастабильных состояний в $\alpha-Si$:Н. И.А. Курова, Н.Н. Ормонт	4	447
О волновых функциях горячих экситонов в полупроводниках с вырожденными зонами. А.В. Ефанов	6	658
Механизм локальной аморфизации сильно легированного интерметаллического полупроводника $Ti_{1-x}V_xCoSb$. В.А. Ромака, Ю.В. Стаднык, Л.Г. Аксельруд, В.В. Ромака, D. Fruchart, P. Rogl, В.Н. Давыдов, Ю.К. Гореленко	7	769
Влияние кислорода на структуру и электронные свойства нанокластеров кремния Si_n ($n = 5, 6, 10, 18$). А.А. Гниденко, В.Г. Завадинский	7	817
Релаксация экситонов в полумагнитных асимметричных двойных квантовых ямах. С.В. Зайцев, А.С. Бричкин, П.С. Дорожкин, G. Vacher	7	831

Примесные резонансные состояния в полупроводниках. В.Я. Алешкин, Л.В. Гавриленко, М.А. Одноблюдов, И.Н. Ясиевич	8	899
Side jump contribution to spin-orbit mediated Hall effects and Berry curvature. E.I. Rashba	8	923
Superfluid-insulator transition in dirty ultracold Fermi gas. B.I. Shklovskii	8	927
О роли экранирования электрон-фононного взаимодействия в релаксации фотовозбужденной электронно-дырочной плазмы в полупроводнике. С.Е. Кумексов	8	938
Transmission distribution, $\mathcal{P}(\ln T)$, of 1D disordered chain: low- T tail. V.M. Apalkov, M.E. Raikh	8	956
Boundary instability of a two-dimensional electron fluid. M.I. Dyakonov	8	998
Spin-orbit terms in multi-subband electron systems: A bridge between bulk and two-dimensional Hamiltonians. K.V. Kavokin, M.E. Portnoi	8	1002
Relaxation processes in a disordered Luttinger liquid. D.A. Bagrets, I.V. Gornyi, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov	8	1007
Фазообразование и фазовые превращения в нанотолщинных пленках системы Bi-Te. Г.М. Ахмедов	9	1025
Особенности спектров люминесценции кристаллов ZnS(O) и ZnS·Cu(O) с позиций теории пересекющихся зон. Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, В.Г. Галстян, Е.М. Гавришук	9	1039
Исследование монокристаллов тройного соединения $CuIn_3Se_5$. И.В. Боднар	9	1046
Цикличность сверхбыстрой автомодуляции спектра поглощения света, возникающей при накачке и стимулированном излучении в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Бронева, А.Н. Кривонос, Т.А. Налет	9	1053
Влияние фазового перехода на энергетический спектр электронов в Ag_2S . Ф.Ф. Алиев, М.Б. Джафаров, Б.А. Таиров, Г.П. Пашаев, А.А. Саддинова, А.А. Кулиев	10	1165
Число Лоренца и фактор Холла в вырожденных полупроводниках при резонансном рассеянии носителей тока. Л.В. Прокофьева, А.А. Шабалдин, В.А. Корчагин, С.А. Немов, Ю.И. Равич	10	1180
Исследование свойств эпитаксиального и слиткового аптимонида галлия. В.П. Хвостиков, С.В. Сорокина, Н.С. Потапович, О.А. Хвостикова, А.С. Власов, Е.П. Ракова, В.М. Андреев	10	1198
Высокочувствительный субмиллиметровый фотоприемник на основе $InSb$. Ю.Б. Васильев, А.А. Усыкова, Н.Д. Ильинская, П.В. Петров, Ю.Л. Иванов	10	1253
Электронный парамагнитный резонанс взаимодействующих спинов в $n-Ge$ II. Изменение ширины и формы линий. А.И. Вейнгер, А.Г. Забродский, Т.В. Тисенск, С.И. Голощапов	11	1301
Расчет электрической емкости самокомпенсированных полупроводников с межцентровыми прыжками одного и двух электронов (на примере кремния с радиационными дефектами). Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, А.Г. Забродский	12	1420
5.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)		
Роль фоновых примесей O и Cu в оптике кристаллов ZnSe с позиций теории пересекющихся зон. Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, Е.М. Гавришук, В.Г. Галстян	2	131

Пространственное распределение дефектов и кинетика неравновесных носителей заряда в вюрцитных кристаллах GaN, легированных Sm, Eu, Er, Tm и дополнительно введенной примесью Zn. М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Ю.В. Кожанова	2	157	Высокочувствительный субмиллиметровый фотоприемник на основе InSb. Ю.Б. Васильев, А.А. Усикова, Н.Д. Ильинская, П.В. Петров, Ю.Л. Иванов	10
Ионизация в электрическом поле DX-центра, связанного с серой, в $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{P}$. Ю.К. Крутоголов	2	171	Электрические свойства, фотопроводимость и фотOLUMИНЕСЦЕНЦИЯ крупнозернистого p-ZnTe. Ю.В. Клевков, С.А. Колосов, В.С. Кривобок, В.П. Мартовицкий, С.Н. Николаев	11
Некоторые аспекты подбора примесей, улучшающих фотоэлектрические характеристики халькогенидных стеклообразных полупроводников. И.И. Бурдиян, В.В. Косюк, Р.А. Пынзарь	2	208	Расчет электрической емкости самокомпенсированных полупроводников с межцентровыми прыжками одного и двух электронов (на примере кремния с радиационными дефектами). Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, А.Г. Забродский	12
Особенности проявления акцепторного состояния золота в кремнии с термодопорами. А.Д. Кириухин, В.В. Григорьев, А.В. Зуев, В.В. Зуев	3	271	5.2. Транспортные явления (PACS 72)	
Влияние ультразвуковой обработки на фотоэлектрические и люминесцентные свойства кристаллов ZnSe. Е.М. Зобов, М.Е. Зобов, Ф.С. Габиров, И.К. Камиллов, Ф.И. Маняхин, Е.К. Наими	3	282	Электрофизические свойства облученного протонами CdSnAs_2 . В.Н. Брудный, Т.В. Ведерникова	1
Определение энергии и концентрации амфотерных дефектов методом дифференциальной обработки температурной зависимости концентрации свободных носителей. А.Г. Никитина, В.В. Зуев	4	389	О предельных значениях добротности термоэлектрических композитов. А.А. Снарский, М.И. Женировский, И.В. Безсуднов	1
Особенности оптических и фотоэлектрических свойств специально не легированных и легированных Си монокристаллов CdS . Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук, Л.В. Булатская, А.Г. Кевшин	4	399	Электрические свойства слоистых монокристаллов FeIn_2Se_4 на переменном токе. Н.Н. Нифтьев, О.Б. Тагиев, М.Б. Мурадов	3
Влияние температуры и интенсивности освещения на образование метастабильных состояний в a-Si:Н. И.А. Курова, Н.Н. Ормонт	4	447	Оптическая ориентация дырок в деформированных наноструктурах. Н.С. Аверкиев, Н.И. Саблина	3
Разработка фотоприемников для преобразователей изображений: легирование кремния селеном из газовой фазы. Ю.А. Астров, В.Б. Шуман, А.Н. Лодыгин, Л.М. Порцель, А.Н. Махова	4	457	Влияние флуктуаций на электронные и фононные процессы и термодинамические параметры Ag_2Te и Ag_2Se в области фазового перехода. С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев	4
У- и Z-люминесценция поликристаллического теллурида кадмия, полученного неравновесной реакцией прямого синтеза компонентов. В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков	5	536	Примесная проводимость монокристаллов $\text{Hg}_3\text{In}_2\text{Te}_6$. Л.А. Косяченко, И.И. Герман, И.М. Раренко, З.И. Захарук, Е.С. Никонюк	5
Собственная люминесценция Tb в металл-полимерных комплексах полиамидокислот. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, Д.М. Жигунов, И.В. Подешво, С.Е. Никитин, П.А. Форш, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский	5	618	Электролюминесценция и фототриггерный эффект в монокристаллах твердых растворов $\text{GaS}_x\text{Se}_{1-x}$. А.Г. Кязым-заде, В.М. Салманов, А.Г. Мохтари, В.В. Дадашова, А.А. Агаева	5
Электронные характеристики однократно ионизированной пары доноров фосфора в кремнии и операции с зарядовыми кубитами. А.Н. Воронько	6	672	О природе затухающих колебаний тока при образовании статического акустоэлектрического домена в гетероструктурах n-InGaAs/GaAs с квантовыми ямами. П.А. Белевский, М.Н. Винославский, В.Н. Порошин, И.В. Строганова	5
Особенности долговременной релаксации емкости в выпрямляющих структурах на основе монокристаллического ZnP_2 n-типа проводимости. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко	6	679	Собственная люминесценция Tb в металл-полимерных комплексах полиамидокислот. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, Д.М. Жигунов, И.В. Подешво, С.Е. Никитин, П.А. Форш, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский	5
Особенности спектров люминесценции кристаллов ZnS(O) и $\text{ZnS} \cdot \text{Cu(O)}$ с позиций теории непересекающихся зон. Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, В.Г. Галстян, Е.М. Гавришук	9	1039	Исследование зависимости электрофизических параметров пленок $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, от уровня легирования индием. В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Д.Г. Икусов, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, Г.Ю. Сидоров, М.В. Якушев	6
Проявление в функции Гоффмана особенностей генерационно-рекомбинационных свойств бистабильных дефектов в полупроводниках. А.Г. Никитина, В.В. Зуев	10	1190	Исследование влияния температуры крекинга мышьяка на эффективность его встраивания в пленки CdHgTe в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии. Г.Ю. Сидоров, Н.Н. Михайлов, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Ю.Г. Сидоров, С.А. Дворецкий	6
Сравнительный анализ предельной эффективности фотопреобразования обычных солнечных элементов и солнечных элементов с квантовыми ямами. А.В. Саченко, И.О. Соколовский	10	1238	CdTe как пассивирующий слой в гетероструктуре CdTe/HgCdTe . И.С. Вирт, И.В. Курило, И.А. Рудый, Ф.Ф. Сизов, Н.Н. Михайлов, Р.Н. Смирнов	7

е усиление g -фактора в гетероструктурах Sb. В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, Конников, С.С. Криштопенко, Ю.Г. Садофьев, Ирин	7	846	Примесная проводимость монокристаллов $Hg_3In_2Te_6$. Л.А. Косяченко, И.И. Герман, И.М. Раренко, З.И. Захарук, Е.С. Никонюк	5	528
p contribution to spin-orbit mediated Hall and Berry curvature. E.I. Rashba	8	923	Механизм локальной аморфизации сильно ле- гированного интерметаллического полупроводника $Ti_{1-x}V_xCoSb$. В.А. Ромака, Ю.В. Стадник, Л.Г. Аксельруд, В.В. Ромака, D. Fruchart, P. Rogl, В.Н. Давыдов, Ю.К. Гореленко	7	769
sion distribution, $\mathcal{P}(\ln T)$, of 1D disordered low- T tail. V.M. Apalkov, M.E. Raikh	8	956	Импульсный пробой диодов Шоттки на основе $4H-SiC$ с охраняемым $p-n$ -переходом, изготовленным имплантацией бора. П.А. Иванов, И.В. Грехов, А.С. Потапов, Т.П. Самсонова	7	878
orientation of electron spins. S.A. Tarasenko	8	982	Влияние магнитного поля на вольт-амперную характеристику гетероперехода $n-GaAs-p-Ge$. М.М. Гаджиалиев, З.Ш. Пирмагомедов	9	1050
ы возбуждения ионов Er^{3+} в SiO_2 с нано- плами Si. А.А. Прокофьев, А.С. Москаленко, Сиевич	8	985	Энергетический спектр носителей заряда в Ag_2Te . Ф.Ф. Алиев, М.Б. Джафаров	11	1297
Поренца и фактор Холла в вырожденных проводниках при резонансном рассеянии теплого тока. Л.В. Прокофьева, А.А. Шабалдин, Урчагин, С.А. Немов, Ю.И. Равич	10	1180	Электрические и гальваномагнитные свойства пленок теллурида кадмия, синтезированных в резко неравновесных условиях. А.П. Беляев, В.П. Рубец, В.В. Антипов, В.В. Гришин	11	1309
Энергетический спектр носителей заряда в Ag_2Te . Алиев, М.Б. Джафаров	11	1297	Электрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников $InSe$ и $GaSe$ при облучении электронами с энерги- ей 12.5 МэВ. З.Д. Ковалюк, О.А. Политанская, О.Н. Сидор, В.Т. Маслюк	11	1321
а МДП структур на основе варизонного эпитекта, выращенного методом молекулярно- эпитаксии. А.В. Войцеховский, С.Н. Несме- -М. Дзядух, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Ихайлов, Ю.Г. Сидоров, В.В. Васильев	11	1327	Расчет электрической емкости самокомпенсирован- ных полупроводников с межцентровыми прыжками одного и двух электронов (на примере кремния с радиационными дефектами). Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, А.Г. Забродский	12	1420
Явления электронной проводимости проводниках (PACS 72.20)			Разъединенный гетеропереход II-типа $GaSb_{1-x}As_x/InAs$ ($x < 0.15$): эволюция зонной энергетической диаграммы тройного твердого раствора. В.В. Романов, К.Д. Моисеев, Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, Ю.П. Яковлев	12	1434
ия стадия эволюции электроно-дырочных в полупроводниках. А.С. Кюрегян	1	23	5.2.2. Высокочастотные эффекты и эффекты обусловленные плазмой (PACS 72.30)		
физические свойства облученного протонами Si_2 . В.Н. Брудный, Т.В. Ведерникова	1	36	Лазерно-стимулированная модификация примесно- го энергетического спектра селенида галлия, интеркалированного кобальтом. И.И. Грыгорчак, А.И. Пелехович, Н.В. Волинская	4	385
ствительность пленок $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ в об- сственного поглощения. А.Э. Климов, Шумский	2	147	Цикличность сверхбыстрой автомодуляции спектра поглощения света, возникающей при накачке и стимулированном излучении в $GaAs$. Н.Н. Агеева, И.Л. Бронева, А.Н. Кривоносов, Т.А. Налет	9	1053
вольтные (900 В) $4H-SiC$ диоды Шоттки раняемым $p-n$ -переходом, изготовленным нтацией бора. И.В. Грехов, П.А. Иванов, Ильинская, О.И. Коньков, А.С. Потапов, Самсонова	2	211	Влияние фазового перехода на энергетический спектр электронов в Ag_2S . Ф.Ф. Алиев, М.Б. Джафаров, Б.А. Таиров, Г.П. Пашаев, А.А. Саддинова, А.А. Кулиев	10	1165
ческие свойства слоистых монокристаллов е, на переменном токе. Н.Н. Нифтиев, Алиев, М.Б. Мурадов	3	268	Субгетерагерцовые автоколебания в сверхбыстрой ав- томодуляции поглощения света в $GaAs$. Н.Н. Агеева, И.Л. Бронева, А.Н. Кривоносов	12	1426
ности проявления акцепторного состояния в кремнии с термодонорами. А.Д. Кирюхин, Григорьев, А.В. Зуев, В.В. Зуев	3	271	5.2.3. Фотопроводимость и фотовольтаиче- ский эффект (PACS 72.40)		
ационная пьезоспектроскопия фотолюмине- н квантовой ямы $GaAs/Al_{0.35}Ga_{0.65}As$: Ве. Аверкиев, Ю.Л. Иванов, А.А. Красивичев, Петров, Н.И. Саблина, В.Е. Седов	3	322	Фоточувствительность пленок $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ в об- ласти собственного поглощения. А.Э. Климов, В.Н. Шумский	2	147
о-стимулированная модификация примесно- энергетического спектра селенида галлия, интеркалированного кобальтом. И.И. Грыгорчак, Пелехович, Н.В. Волинская	4	385			
чение энергии и концентрации амфотерных проводников методом дифференциальной обработки температурной зависимости концентрации свобод- носителей. А.Г. Никитина, В.В. Зуев	4	389			
е поперечного магнитного поля на поведение поперечных автосолиитонов в $p-InSb$. И.К. Камилов, Степуренко, А.Э. Гумметов, А.С. Ковалев	4	393			
е флуктуаций на электронные и фононные моды и термодинамические параметры Ag_2Te и Se в области фазового перехода. С.А. Алиев, Алиев	4	404			

Влияние ультразвуковой обработки на фотоэлектрические и люминесцентные свойства кристаллов ZnSe. Е.М. Зобов, М.Е. Зобов, Ф.С. Габибов, И.К. Камиллов, Ф.И. Маняхин, Е.К. Наими	3	282	Диагностика низкобарьерных диодов Шоттки с поверхностным δ -легированием. В.И. Шашкин, А.В. Мурель	4	500
Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллических соединений $\text{AgCd}_2\text{GaS}_4$. Л.В. Булатецкая, В.В. Божко, Г.Е. Давидюк, О.В. Парасюк	5	522	Исследование свойств поверхности арсенида галлия методом сканирующей атомно-силовой микроскопии. В.Г. Божков, Н.А. Торхов, И.В. Ивонин, В.А. Новиков	5	546
Высокочувствительный субмиллиметровый фотоприемник на основе InSb. Ю.Б. Васильев, А.А. Усикова, Н.Д. Ильинская, П.В. Петров, Ю.Л. Иванов	10	1253	Резонансное туннелирование носителей в фотовозбужденных гетероструктурах 2-го типа ZnSe/BeTe. С.В. Зайцев, А.А. Максимов, И.И. Тартаковский, Д.Р. Яковлев, А. Ваг	5	555
Фотоэлектрические свойства, фотопроводимость и фотолюминесценция крупнозернистого p -ZnTe. Ю.В. Клевков, С.А. Колосов, В.С. Кривобок, В.П. Мартовичский, С.Н. Николаев	11	1291	Теоретическое исследование процессов ожереккомбинации в глубоких квантовых ямах. Л.В. Данилов, Г.Г. Зегря	5	566
Электрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников InSe и GaSe при облучении электронами с энергией 12.5 МэВ. З.Д. Ковалюк, О.А. Политанская, О.Н. Сидор, В.Т. Маслюк	11	1321	Пороговые характеристики ИК-лазера на основе глубоких квантовых ям InAsSb/AlSb. Л.В. Данилов, Г.Г. Зегря	5	573
5.3. Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)			О природе затухающих колебаний тока при образовании статического акустоэлектрического домена в гетероструктурах n -InGaAs/GaAs с квантовыми ямами. П.А. Белевский, М.Н. Винославский, В.Н. Порошин, И.В. Строганова	5	604
Глубокие уровни и электронный транспорт в гетероструктурах AlGaIn/GaN. И.В. Антонова, В.И. Поляков, А.И. Руковишников, В.Г. Мансуров, К.С. Журавлев	1	53	О механизме токопереноса, обусловленном дислокациями в нитридгаллиевых диодах Шоттки. А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, В.П. Кладько, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, А.В. Кучук, В.В. Миленин, Ю.Н. Свешников, В.Н. Шеремет	6	706
Сэндвич-структура InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников. Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин	1	101	Гибридно-фононные резонансы в квантовом канале. В.В. Карпунин, В.А. Маргулис	6	711
Фазовый состав пленок системы Bi-S и формирование Bi_2S_3 с различной субструктурой. Г.М. Ахмедов	2	129	Формирование сверхизлучения в наногетероструктурах с квантовыми точками. А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря	6	730
Фотопроводимость тонких пленок аморфного гидрированного кремния. А.Г. Казанский, О.Г. Кошелев, А.Ю. Сазонов, А.А. Хомич	2	192	Периодическое создание кратковременной инверсии населенностей на межподзонных лазерных переходах в квантовых ямах. В.А. Кукушкин	7	810
Снижение подвижности электронов в канале металл-окисел-полупроводник транзистора при уменьшении длины затвора. А.А. Французов, Н.И. Бояркина, В.П. Попов	2	215	Влияние кислорода на структуру и электрошные свойства нанокластеров кремния Si_n ($n = 5, 6, 10, 18$). А.А. Гниденко, В.Г. Заводинский	7	817
Электрические свойства слоистых монокристаллов FeIn_2Se_4 на переменном токе. Н.Н. Нифтиев, О.Б. Тагиев, М.Б. Мурадов	3	268	Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaAsN/InGaAsN на подложках GaAs. В.В. Мамутин, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, В.С. Михрин, А.М. Надточий, Е.В. Пирогов	7	823
Роль процессов переноса неравновесных носителей заряда в излучательных свойствах массивов InAs/GaAs-квантовых точек. А.С. Школьник, А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря, S. Pellegrini, G.S. Buller, В.П. Евтихийев	3	296	Релаксация экситонов в полумангнитных асимметричных двойных квантовых ямах. С.В. Зайцев, А.С. Бричкин, П.С. Дорожкин, G. Vacher	7	831
Фотолюминесценция с длиной волны до 1.6 мкм в квантовых точках с увеличенной эффективной толщиной слоя InAs. М.Н. Дроздов, Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.И. Шашкин	3	303	Обменное усиление g -фактора в гетероструктурах InAs/AlSb. В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, А.В. Иконников, С.С. Криштопенко, Ю.Г. Садофьев, К.Е. Спириин	7	846
Эффект Ваннье-Штарка в сверхрешетке квантовых точек Ge/Si. М.М. Соболев, Г.Э. Цырлин, А.А. Тонких, Н.Д. Захаров	3	311	Управление заселенностью верхней рабочей подзоны электрическим полем в структурах с асимметричными барьерами для униполярного лазера. Ю.А. Алещенко, А.Е. Жуков, В.В. Капаев, Ю.В. Капаев, П.С. Копьев, В.М. Устинов	7	856
Влияние условий осаждения и отжига пленок легированного фтором оксида индия (IFO) на фотоэлектрические свойства гетероперехода IFO/ p -Si. Г.Г. Унтила, Т.Н. Кост, А.Б. Чеботарева, М.Б. Закс, А.М. Ситников, О.И. Солодуха	4	415	Residual resistance and Joule heat generation in bulk samples and nanostructures. V. L. Gurevich	8	931
			Теория каталитической диссоциации атомов водорода на поверхности металла. О.В. Константинов, В.Д. Дымников, М.А. Митцев	8	947

Magnetotransport in a 2D system with strong scatterers: renormalization of Hall coefficient caused by non-Markovian effects. A.P. Dmitriev, V.Yu. Kachorovskii .	8	950
Особенности оптической ориентации и релаксации электронных спинов в квантовых ямах с большим спиновым расщеплением. Н.С. Аверкиев, М.М. Глазов .	8	973
Thermal orientation of electron spins. S.A. Tarasenko .	8	982
Процессы возбуждения ионов Er^{3+} в SiO_2 с нанокристаллами Si. А.А. Прокофьев, А.С. Москаленко, И.Н. Ясевич .	8	985
Эффекты самосогласованного электростатического потенциала в квантовых ямах с несколькими уровнями размерного квантования в сильных магнитных полях. А.А. Грешнов, Г.Г. Зегря .	8	994
Spin-orbit terms in multi-subband electron systems: A bridge between bulk and two-dimensional Hamiltonians. K.V. Kavokin, M.E. Portnoi .	8	1002
Relaxation processes in a disordered Luttinger liquid. D.A. Bagrets, I.V. Gornyi, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov .	8	1007
Фазообразование и фазовые превращения в нанотолщинных пленках системы $\text{Bi}-\text{Te}$. Г.М. Ахмедов .	9	1025
Барические свойства квантовых точек InAs . Б.В. Новиков, Г.Г. Зегря, Р.М. Пелешак, О.О. Данькин, В.А. Гайсин, В.Г. Талалаев, И.В. Штром, Г.Э. Цырлин .	9	1094
Электрофизические и структурные свойства двусторонне δ -легированных РНЕМТ-гетероструктур на основе $\text{AlGaAs}/\text{InGaAs}/\text{AlGaAs}$. И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов, В.Г. Мокеров, С.С. Широков, Р.М. Имамов, И.А. Субботин .	9	1102
Эмиссия электронов из многослойных ансамблей вертикально связанных квантовых точек InAs в матрице $n\text{-GaAs}$. А.А. Гуткин, П.Н. Брунков, А.Ю. Егоров, А.Е. Жуков, С.Г. Конников .	9	1122
Исследование свойств эпитаксиального и слиткового антимонида галлия. В.П. Хвостиков, С.В. Сорокина, Н.С. Потапович, О.А. Хвостикова, А.С. Власов, Е.П. Ракова, В.М. Андреев .	10	1198
Учет спонтанной поляризации в задаче о гетероструктуре $\text{NH-SiC}/\text{3C-SiC}/\text{NH-SiC}$, образованной кубическим (3C) и гексагональными (NH) поли типами карбида кремния. С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин .	10	1206
Роль флуктуаций потенциала в энергетической структуре квантовых ям $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$ с A^+ -центрами. П.В. Петров, Ю.Л. Иванов, В.С. Михрин, А.Е. Жуков .	10	1219
Влияние примесей на постоянную составляющую тока в квантовой нити в условиях совместного воздействия постоянного и переменного электрических полей. Д.В. Завьялов, С.В. Крючков .	10	1223
Сравнительный анализ предельной эффективности фотопреобразования обычных солнечных элементов и солнечных элементов с квантовыми ямами. А.В. Саченко, И.О. Соколовский .	10	1238
Каталитические свойства композитных слоев аморфный углерод—платина в топливных элементах. А.А. Нечитайлов, Т.К. Звонарева, А.Д. Ременюк, В.А. Толмачев, Д.Н. Горячев, О.С. Ельцина, Л.В. Беляков, О.М. Сресели .	10	1268
Роль спонтанной поляризации в формировании структур $\text{NH-SiC}/\text{3C-SiC}/\text{NH-SiC}$ на основе поли типов карбида кремния. С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин .	11	1318

Свойства МДП структур на основе варизонного HgCdTe , выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии. А.В. Войцеховский, С.Н. Несмелов, С.М. Дзядух, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.В. Васильев	11	1327
Решение задачи инжекции носителей тока в изолирующий слой при самосогласованных граничных условиях на контактах. В.И. Шашкин, Н.В. Востоков .	11	1339
Оптические свойства голубых светодиодов в системе InGaN/GaN при высокой плотности тока. Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Ю.С. Леликов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, А.С. Белов, Ю.Г. Шретер	11	1384
Исследование промежуточного слоя на гетерогранице $n^+-\text{CdS}/p\text{-CdTe}$. С.А. Музафарова, Б.У. Айтбаев, Ш.А. Мирсагатов, К. Дуршимбетов, Ж. Жанабергенов	12	1409
Электрические свойства гетероэпитаксиальных слоев HgCdTe n -типа проводимости, модифицированных ионным травлением. М. Поцяск, И.И. Ижнин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.С. Варавин, К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский .	12	1444
Энергия связи экситона и X^+ -, X^- -трионов в одномерных системах. М.А. Семина, Р.А. Сергеев, Р.А. Сурис	12	1459

5.3.1. Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20)

Зависимость изгиба зон на границе микроконтакта $\text{AgBr}-\text{AgI}$ от формы и размера гетерогенной системы. А.В. Ханефт, А.С. Поплавной, Б.А. Сечкарев, Л.В. Сотникова	1	40
Глубокие уровни и электронный транспорт в гетероструктурах $\text{AlGaIn}/\text{GaIn}$. И.В. Антонова, В.И. Поляков, А.И. Руковишников, В.Г. Мансуров, К.С. Журавлев	1	53
Электрофизические свойства слоев $\text{Si}:\text{Er}/\text{Si}$, выращенных методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии. О.В. Белова, В.Н. Шабанов, А.П. Касаткин, О.А. Кузнецов, А.Н. Яблонский, М.В. Кузнецов, В.П. Кузнецов, А.В. Корнаухов, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник	2	136
Оптические свойства твердых растворов $\text{AgGa}_{1-x}\text{In}_x\text{Se}_2$. И.В. Боднар	2	153
Снижение подвижности электронов в капале металл—окисел—полупроводник транзистора при уменьшении длины затвора. А.А. Французов, Н.И. Бояркина, В.П. Попов	2	215
О способах иснарения Si и легирующих примесей в методах вакуумной эпитаксии. В.П. Кузнецов, Н.А. Алябина, В.А. Боженкин, О.В. Белова, М.В. Кузнецов	3	257
Роль процессов переноса неравновесных носителей заряда в излучательных свойствах массивов InAs/GaAs -квантовых точек. А.С. Школьник, А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря, S. Pellegri, G.S. Buller, В.П. Евтихийев	3	296
Эффект Ванье—Штарка в сверхрешетке квантовых точек Ge/Si . М.М. Соболев, Г.Э. Цырлин, А.А. Тонких, Н.Д. Захаров	3	311

Оптическая ориентация дырок в деформированных наноструктурах. Н.С. Аверкиев, Н.И. Саблина . . .	3	316
Поляризационная незоспектроскопия фотолюминесценции квантовой ямы GaAs/Al _{0.35} Ga _{0.65} As: Be. Н.С. Аверкиев, Ю.Л. Иванов, А.А. Красивичев, П.В. Петров, Н.И. Саблина, В.Е. Седов	3	322
Механизм формирования отклика газового сенсора водорода на основе кремниевого МОП диода. В.И. Гаман, В.И. Балюба, В.Ю. Грицык, Т.А. Давыдова, В.М. Калыгина	3	341
Высококачественные свойства двухъямных наноструктур. В.Ф. Елесин, И.Ю. Катеев	5	586
Гистерезис туннельного тока в двухбарьерных структурах w-GaN/AlGaN(0001). А.Н. Разжувалов, С.Н. Гриняев	5	595
Каскадный лазер на мелких донорах в δ-легированных сверхрешетках GaAs/AlGaAs. Н.А. Бекин, В.Н. Шастиа	5	622
Электронные характеристики однократно ионизированной пары доноров фосфора в кремнии и операции с зарядовыми кубитами. А.Н. Воронько .	6	672
О механизме токопереноса, обусловленном дислокациями в нитридгаллиевых диодах Шоттки. А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, В.П. Кладько, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, А.В. Кучук, В.В. Миленин, Ю.Н. Свешников, В.Н. Шеремет	6	706
Формирование сверхизлучения в наногетероструктурах с квантовыми точками. А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря	6	730
CdTe как массивирующий слой в гетероструктуре CdTe/HgCdTe. И.С. Вирт, И.В. Курило, И.А. Рудый, Ф.Ф. Сизов, Н.Н. Михайлов, Р.Н. Смирнов	7	788
Нановключения InGaN в матрице AlGaN. В.С. Сизов, А.Ф. Цацунчиков, В.В. Лундин	7	804
Релаксация экситонов в полумагнитных асимметричных двойных квантовых ямах. С.В. Зайцев, А.С. Бричкин, П.С. Дорожкин, G. Vacher	7	831
Обменное усиление g-фактора в гетероструктурах InAs/AlSb. В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, А.В. Иконников, С.С. Криштопенко, Ю.Г. Садофьев, К.Е. Спирин	7	846
Теория каталитической диссоциации атомов водорода на поверхности металла. О.В. Константинов, В.Д. Дымников, М.А. Митцев	8	947
Transmission distribution, $\mathcal{P}(\ln T)$, of 1D disordered chain: low-T tail. V.M. Apalkov, M.E. Raikh	8	956
Relaxation processes in a disordered Luttinger liquid. D.A. Bagrets, I.V. Gornyi, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov	8	1007
Учет спонтанной поляризации в задаче о гетероструктуре NH-SiC/3C-SiC/NH-SiC, образованной кубическим (3C) и гексагональными (NH) поли типами карбида кремния. С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин	10	1206
Роль спонтанной поляризации в формировании структур NH-SiC/3C-SiC/NH-SiC на основе поли тинов карбида кремния. С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин	11	1318
Свойства МДП структур на основе варизонного HgCdTe, выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии. А.В. Войцеховский, С.Н. Несмелов, С.М. Дзядух, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.В. Васильев	11	1327

Разъединенный гетеропереход II-типа GaSb _{1-x} As _x /InAs ($x < 0.15$): эволюция зонной энергетической диаграммы тройного твердого раствора. В.В. Романов, К.Д. Моисеев, Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, Ю.П. Яковлев	12	1434
Поверхностные состояния на границе раздела n-InN-электролит. А.А. Гуткин, М.Э. Рудинский, П.Н. Брунков, А.А. Ключихин, В.Ю. Давыдов, Н.-Y. Chen, S. Gwo	12	1448

5.3.2. Барьеры Шоттки (PACS 73.30)

Оптические свойства твердых растворов AgGa _x In _{1-x} Se ₂ . И.В. Боднар	2	153
Диагностика низкобарьерных диодов Шоттки с приповерхностным δ-легированием. В.И. Шашкин, А.В. Мурель	4	500
Особенности долговременной релаксации емкости в выпрямляющих структурах на основе моноклинического ZnP ₂ n-типа проводимости. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко	6	679
Свойства барьерных контактов к InP с напоразмерными слоями TiV _x . И.Н. Арсентьев, А.В. Бобыль, И.С. Тарасов, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, А.Е. Беляев, А.Б. Камалов, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, Е.В. Руссу	7	793
Влияние электрического поля на фотоэффект в барьерах Шоттки на электронном дифосфиде кадмия. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко	9	1079
Структурные и энергетические характеристики собственных дефектов вакансионного типа в двуоснаправленной решетке GaN. Т.В. Безъязычная, В.М. Зеленковский, А.Л. Гурский, Г.И. Рябцев	11	1281
Решение задачи инжекции носителей тока в изолирующий слой при самосогласованных граничных условиях на контактах. В.И. Шашкин, Н.В. Востоков	11	1339
Оптические свойства голубых светодиодов в системе InGaN/GaN при высокой плотности тока. Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Ю.С. Леликов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, А.С. Белов, Ю.Г. Шретер	11	1384
Быстрые оптические регистрирующие среды на полупроводниковых наноструктурах для записи и обработки изображений. П.Г. Кашеринин, А.А. Томасов	11	1391

5.3.3. Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40)

Зависимость изгиба зон на границе микроконтакта AgBr-AgI от формы и размера гетерогенной системы. А.В. Ханефт, А.С. Поплавной, Б.А. Сечкарев, Л.В. Сотникова	1	40
Глубокие уровни и электронный транспорт в гетероструктурах AlGaIn/GaN. И.В. Антонова, В.И. Поляков, А.И. Руковишников, В.Г. Мансуров, К.С. Журавлев	1	53
Восстановление профиля потенциала в изолирующем слое по вольт-амперным характеристикам туннельных МДП диодов. Е.И. Гольдман, А.Г. Ждан, Н.Ф. Кухарская, М.В. Черняев	1	94

Электрофизические свойства слоев Si:Er/Si, выращенных методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии . О.В. Белова, В.Н. Шабанов, А.П. Касаткин, О.А. Кузнецов, А.Н. Яблонский, М.В. Кузнецов, В.П. Кузнецов, А.В. Корнаухов, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник	2	136	Свойства барьерных контактов к InP с наноразмерными слоями TiV _x . И.Н. Арсентьев, А.В. Бобыль, И.С. Тарасов, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, А.Е. Беляев, А.Б. Камалов, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, Е.В. Руссу	7	793
Снижение подвижности электронов в канале металл—окисел—полупроводник транзистора при уменьшении длины затвора. А.А. Французов, Н.И. Бояркина, В.П. Попов	2	215	Адмитанс и нелинейная емкость многослойной структуры металл—полупроводник. Н.В. Востоков, В.И. Шашкин	7	799
О способах испарения Si и легирующих примесей в методах вакуумной эпитаксии. В.П. Кузнецов, Н.А. Алябина, В.А. Боженкин, О.В. Белова, М.В. Кузнецов	3	257	Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaAsN/InGaAsN на подложках GaAs. В.В. Мамутин, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, В.С. Михрин, А.М. Надточий, Е.В. Пирогов	7	823
Сравнительный анализ фото- и электролюминесценции многослойных структур с самоформирующимися островками Ge(Si)/Si(001). Ю.Н. Дроздов, З.Ф. Красильник, К.Е. Кудрявцев, Д.Н. Лобанов, А.В. Новиков, М.В. Шалесов, Д.В. Шенгуров, В.Б. Шмагин, А.Н. Яблонский	3	291	Measurement and comparison of silicon $p-i-n$ -photodiodes ac impedance at different voltages. S. Özden, H. Bayhan, A. Dönmez, M. Bayhan	7	852
Механизм формирования отклика газового сенсора водорода на основе кремниевого МОП диода. В.И. Гаман, В.И. Балуба, В.Ю. Грицык, Т.А. Давыдова, В.М. Калыгина	3	341	Magnetotransport in a 2D system with strong scatterers: renormalization of Hall coefficient caused by non-Markovian effects. A.P. Dmitriev, V.Yu. Kachorovskii	8	950
Electrical properties of InP/InGaAs rnr heterostructure-emitter bipolar transistor. Jung-Hui Tsai, Wen-Chau Liu, Der-Feng Guo, Yu-Chi Kang, Shao-Yen Chiu, Wen-Shiung Lour	3	353	Влияние магнитного поля на вольт-амперную характеристику гетероперехода n -GaAs— p -Ge. М.М. Гаджалиев, З.Ш. Пирмагомедов	9	1050
Влияние условий осаждения и отжига пленок легированного фтором оксида индия (IFO) на фотоэлектрические свойства гетеронперехода IFO/ p -Si. Г.Г. Унтила, Т.Н. Кост, А.Б. Чеботарева, М.Б. Закс, А.М. Ситников, О.И. Солодуха	4	415	Влияние электрического поля на фотоэффект в барьерах Шоттки на электронном дифосфиде кадмия. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко	9	1079
Собственный окисел, возникающий на поверхности скола селенида галлия в результате длительного хранения. С.И. Драпак, С.В. Гаврилюк, З.Д. Ковалюк, О.С. Литвин	4	423	Автосолиитоны в бистабильной системе кремния с глубокими примесными уровнями. А.М. Мусаев	10	1168
Термостойкий диод Шоттки TiV _x — n -GaP. А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, А.Б. Камалов, Л.М. Капитанчук, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, М.У. Насыров	4	463	Электрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников InSe и GaSe при облучении электронами с энергией 12.5 МэВ. З.Д. Ковалюк, О.А. Политанская, О.Н. Сидор, В.Т. Маслюк	11	1321
Диагностика низкобарьерных диодов Шоттки с приповерхностным δ -легированием. В.И. Шашкин, А.В. Мурель	4	500	Свойства МДП структур на основе варизонного HgCdTe, выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии. А.В. Войцеховский, С.Н. Несмелов, С.М. Дзядх, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.В. Васильев	11	1327
Резонансное туннелирование носителей в фотовозбужденных гетероструктурах 2-го типа ZnSe/BeTe. С.В. Зайцев, А.А. Максимов, И.И. Тартаковский, Д.Р. Яковлев, А. Ваг	5	555	Статические вольт-амперные характеристики туннельных МДП структур Au/CaF ₂ / n -Si(111). С.М. Сутурин, А.Г. Банщиков, Н.С. Соколов, С.Э. Тягинов, М.И. Векслер	11	1333
Гистерезис туннельного тока в двухбарьерных структурах w -GaN/AlGaN(0001). А.Н. Разжувалов, С.Н. Гриняев	5	595	Решение задачи инжекции носителей тока в изолирующей слой при самосогласованных граничных условиях на контактах. В.И. Шашкин, Н.В. Востоков	11	1339
Особенности долговременной релаксации емкости в выпрямляющих структурах на основе моноклинного ZnP ₂ n -типа проводимости. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко	6	679	Зависимость механизма протекания тока в сплавном омическом контакте In— n -GaN от концентрации основных носителей заряда. В.Н. Бессолов, Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг, О.В. Константинов, Е.А. Поссе	11	1345
Релаксация параметров тонкопленочных электролюминесцентных структур на основе ZnS:Mn при выключении. Н.Т. Гурин, О.Ю. Сабитов	6	692	Особенности световых вольт-амперных характеристик $p-i-n$ -структур на аморфном кремнии при туннельно-дрейфовом механизме переноса темнового тока. А.А. Андреев	11	1363
О механизме токопереноса, обусловленном дислокациями в нитридгаллиевых диодах Шоттки. А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, В.П. Кладько, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, А.В. Кучук, В.В. Миленин, Ю.Н. Свешников, В.Н. Шеремет	6	706	Особенности вольт-фарадных характеристик МОП структур, обусловленные зарядом в окисле. Е.А. Боброва, Н.М. Омеляновская	11	1380
			Исследование промежуточного слоя на гетерогранице n^+ -CdS/ p -CdTe. С.А. Музафарова, Б.У. Айтбаев, Ш.А. Мирсагатов, К. Дуршимбетов, Ж. Жанаберганов	12	1409

Разъединенный гетеропереход II-типа GaSb _{1-x} As _x /InAs ($x < 0.15$): эволюция зонной энергетической диаграммы тройного твердого раствора. В.В. Романов, К.Д. Моисеев, Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, Ю.П. Яковлев	12	1434
Гигантский всплеск ударной ионизации в $p-n$ -переходе политипа 6H-SiC. В.И. Санкин, П.П. Шкретский	12	1439
Поверхностные состояния на границе раздела n -InN-электролит. А.А. Гуткин, М.Э. Рудинский, П.Н. Брунков, А.А. Клочихин, В.Ю. Давыдов, Н.-Y. Chen, S. Gwo	12	1448
5.3.4. Транспортные явления в тонких пленках (PACS 73.50)		
Фотонпроводимость тонких пленок аморфного гидрированного кремния. А.Г. Казанский, О.Г. Кошелев, А.Ю. Сазонов, А.А. Хомич	2	192
Исследование проводимости сверхтонких пленок бифталоцианина олова. Н.Л. Левшин, Н.Н. Пронин, П.А. Форш, С.Г. Юдин	2	199
Некоторые аспекты подбора примесей, улучшающих фотоэлектрические характеристики халькогенидных стеклообразных полупроводников. И.И. Бурдиян, В.В. Косюк, Р.А. Пынзарь	2	208
Низкотемпературные аномалии фотоэлектромагнитного эффекта в p -Cd _x Hg _{1-x} Te, обусловленные перезарядкой поверхностных состояний. С.Г. Гасанзаде, М.В. Стриха, Г.А. Шепельский	4	431
Электролюминесценция и фототриггерный эффект в монокристаллах твердых растворов GaS _x Se _{1-x} . А.Г. Кязымзаде, В.М. Салманов, А.Г. Мохтари, В.В. Дадашова, А.А. Агаева	5	532
Гистерезис туннельного тока в двухбарьерных структурах w -GaN/AlGaN(0001). А.Н. Разжувалов, С.Н. Гриняев	5	595
О природе затухающих колебаний тока при образовании статического акустоэлектрического домена в гетероструктурах n -InGaAs/GaAs с квантовыми ямами. П.А. Белевский, М.Н. Винославский, В.Н. Порошин, И.В. Строганова	5	604
Magnetotransport in a 2D system with strong scatterers: renormalization of Hall coefficient caused by non-Markovian effects. А.Р. Dmitriev, V.Yu. Kachorovskii	8	950
Влияние электрического поля на фотоэффект в барьерах Шоттки на электронном дифосфиде кадмия. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко	9	1079
Электрофизические и структурные свойства двусторонне δ -легированных PHEMT-гетероструктур на основе AlGaAs/InGaAs/AlGaAs. И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов, В.Г. Мокеров, С.С. Широков, Р.М. Имамов, И.А. Субботин	9	1102
Влияние фазового перехода на энергетический спектр электронов в Ag ₂ S. Ф.Ф. Алиев, М.Б. Джафаров, Б.А. Таиров, Г.П. Пашаев, А.А. Саддинова, А.А. Кулиев	10	1165
Особенности влияния электронной и нейтронной радиации на фотоэлектрические свойства специально легированных и легированных Си монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л.В. Булатецкая	10	1263

Каталитические свойства композиционных слоев аморфный углерод—платина в топливных элементах. А.А. Нечитайлов, Т.К. Звонарева, А.Д. Ременюк, В.А. Толмачев, Д.Н. Горячев, О.С. Ельцина, Л.В. Беляков, О.М. Сресели	10	1268
Электрические и гальваномагнитные свойства пленок теллурида кадмия, синтезированных в резко неравновесных условиях. А.П. Беляев, В.П. Рубец, В.В. Антипов, В.В. Гришин	11	1309
Особенности световых вольт-амперных характеристик $p-i-n$ -структур на аморфном кремнии при туннельно-дрейфовом механизме переноса темпового тока. А.А. Андреев	11	1363
Гигантский всплеск ударной ионизации в $p-n$ -переходе политипа 6H-SiC. В.И. Санкин, П.П. Шкретский	12	1439
5.4. Сверхпроводимость (PACS 74). Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76)		
О предельных значениях добротности термоэлектрических композитов. А.А. Снарский, М.И. Женировский, И.В. Безсуднов	1	82
Лазерно-стимулированная модификация примесного энергетического спектра селенида галлия, интеркалированного кобальтом. И.И. Грыгорчак, А.И. Пелехович, Н.В. Волынская	4	385
Магнитная восприимчивость твердых растворов Bi ₂ Te ₃ -Sb ₂ Te ₃ . Н.П. Степанов, А.К. Гильфанов, Л.Д. Иванова, Ю.В. Гранаткина	4	410
Низкотемпературные аномалии фотоэлектромагнитного эффекта в p -Cd _x Hg _{1-x} Te, обусловленные перезарядкой поверхностных состояний. С.Г. Гасанзаде, М.В. Стриха, Г.А. Шепельский	4	431
Разработка фотоприемников для преобразователей изображений: легирование кремния селеном из газовой фазы. Ю.А. Астров, В.Б. Шуман, А.Н. Лодыгин, Л.М. Порцель, А.Н. Махова	4	457
Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллических соединений AgCd ₂ GaS ₄ . Л.В. Булатецкая, В.В. Божко, Г.Е. Давидюк, О.В. Парасюк	5	522
Резонансное спиновое усиление в наноструктурах с анизотропной спиновой релаксацией и разбросом электронного g -фактора. М.М. Глазов, Е.Л. Ивченко	8	966
Thermal orientation of electron spins. S.A. Tarasenko	8	982
Эффекты самосогласованного электростатического потенциала в квантовых ямах с несколькими уровнями размерного квантования в сильных магнитных полях. А.А. Грешнов, Г.Г. Зегря	8	994
Влияние магнитного поля на вольт-амперную характеристику гетероперехода n -GaAs- p -Ge. М.М. Гаджалиев, З.Ш. Пирмагомедов	9	1050
Вызванные действием магнитного поля изменения примесного состава и микротвердости приповерхностных слоев кристаллов кремния. В.А. Макара, М.А. Васильев, Л.П. Стебленко, О.В. Коплак, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, С.Н. Науменко	9	1061
Магнитофотолуминесценция в разъединенном гетеропереходе II типа n -GaInAsSb/ p -InAs. К.Д. Моисеев, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев, К. Королев, С. Meinning, В. McCombe	9	1126

Месбауэровские U^- -центры как инструмент исследования бозе-конденсации в полупроводниках. Г.А. Бордовский, С.А. Немов, А.В. Марченко, П.П. Серегин, А.В. Зайцева	10	1172	Пространственное распределение дефектов и кинетика неравновесных носителей заряда в вюрцитных кристаллах GaN, легированных Sm, Eu, Er, Tm и дополнительно введенной примесью Zn. М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Ю.В. Кожанова	2	157
Электронный парамагнитный резонанс взаимодействующих спинов в n -Ge II. Изменение ширины и формы линий. А.И. Вейнгер, А.Г. Забродский, Т.В. Тиснек, С.И. Голощапов	11	1301	Стимулированное излучение гетероструктур на основе $Cd_xHg_{1-x}Te$ при комнатной температуре в условиях оптической накачки. А.А. Андронов, Ю.Н. Ноздрин, А.В. Окомельков, А.А. Бабенко, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Р.Н. Смирнов	2	177
Свойства и структура стекол $(As_2Se_3)_{1-z}(SnSe_2)_z-x(Tl_2Se)_x$ и $(As_2Se_3)_{1-z}(SnSe)_z-x(Tl_2Se)_x$. Г.А. Бордовский, А.В. Марченко, Е.И. Теруков, П.П. Серегин, Т.В. Лиходеева	11	1353	Действие мощных пико- и фемтосекундных лазерных импульсов на кремниевые наноструктуры. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, В.А. Володин, Д.В. Марин, М. Deutschmann	2	181
5.5. Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства (PACS 77)			Фотолюминесценция локализованных экситонов в квантовых точках InGaN. С.О. Усов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин, А.В. Сахаров, Е.Е. Заварин, Н.Н. Леденцов	2	187
Влияние примеси йода на релаксацию фотовозбужденного хлорида серебра. Ю.В. Вострикова, В.Г. Ключев	3	277	Оптические исследования пленок AlN/ n -Si (100), полученных методом высокочастотного магнетронного распыления. Н.С. Заяц, В.Г. Бойко, П.А. Генцарь, О.С. Литвин, В.П. Папуша, Н.В. Сопинский	2	195
Оптическая ориентация дырок в деформированных наноструктурах. Н.С. Аверкиев, Н.И. Саблина	3	316	Сравнительный анализ фото- и электролюминесценции многослойных структур с самоформирующимися островками Ge(Si)/Si(001). Ю.Н. Дроздов, З.Ф. Красильник, К.Е. Кудрявцев, Д.Н. Лобанов, А.В. Новиков, М.В. Шалесев, Д.В. Шенгуров, В.Б. Шмагин, А.Н. Яблонский	3	291
Поляризационная пьезоспектроскопия фотолюминесценции квантовой ямы GaAs/Al _{0,35} Ga _{0,65} As:Ве. Н.С. Аверкиев, Ю.Л. Иванов, А.А. Красивичев, П.В. Петров, Н.И. Саблина, В.Е. Седов	3	322	Фотолюминесценция с длиной волны до 1.6 мкм в квантовых точках с увеличенной эффективной толщиной слоя InAs. М.Н. Дроздов, Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.И. Шашкин	3	303
О природе затухающих колебаний тока при образовании статического акустоэлектрического домена в гетероструктурах n -InGaAs/GaAs с квантовыми ямами. П.А. Белевский, М.Н. Винославский, В.Н. Порошин, И.В. Строганова	5	604	Поляризационная пьезоспектроскопия фотолюминесценции квантовой ямы GaAs/Al _{0,35} Ga _{0,65} As:Ве. Н.С. Аверкиев, Ю.Л. Иванов, А.А. Красивичев, П.В. Петров, Н.И. Саблина, В.Е. Седов	3	322
Фундаментальные спектры оптических функций ферроэлектрика нитрита натрия. В.В. Соболев, А.И. Калугин, В.Вал. Соболев, С.Г. Исхакова	7	777	Спектры излучения гетероструктур с квантовыми ямами типа InGaN/AlGaIn/GaN: модель двумерной комбинированной плотности состояний. М.Л. Бадгутдинов, А.Э. Юнович	4	438
Учет спонтанной поляризации в задаче о гетероструктуре NH-SiC/ \mathcal{Z} C-SiC/NH-SiC, образованной кубическим (\mathcal{Z} C) и гексагональными (NH) политипами карбида кремния. С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин	10	1206	Нелинейно-оптическое преобразование частоты в двухцветном лазере с вертикальным внешним резонатором. Ю.А. Морозов, И.С. Нефедов, Т. Leinonen, М.Ю. Морозов	4	473
Роль спонтанной поляризации в формировании структур NH-SiC/ \mathcal{Z} C-SiC/NH-SiC на основе политипов карбида кремния. С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин	11	1318	Инфракрасные спектры пропускания фотолюминесцентных пленок оксидов с Si-, Ge-квантовыми точками, сформированных импульсным лазерным осаждением. И.П. Лисовский, С.А. Злобин, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Е.В. Бегун	5	560
5.6. Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)			Усиление фотолюминесценции структур с напocrиcтaлличecким кремнием, стимулированное низкодозовым γ -облучением. И.П. Лисовский, И.З. Индутный, М.В. Муравская, В.В. Войтович, Е.Г. Гуле, П.Е. Шепелявый	5	591
Эмиссия горячих электронов, возбужденных в ходе каталитической реакции, из металла в полупроводник. В.Ф. Харламов, А.В. Костин, М.В. Кубышкина, Ф.В. Харламов	1	60	Особенности долговременной релаксации емкости в выпрямляющих структурах на основе моноклиничного ZnP ₂ n -типа проводимости. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко	6	679
Каналы излучательной рекомбинации в Si/Si _{1-x} Ge _x -наноструктурах. Ю.А. Берашевич, А.С. Панфиленок, В.Е. Борисенко	1	68	Рентгеноспектральный микроанализ полупроводниковых эпитаксиальных гетероструктур на основе моделирования транспорта электронов методом Монте-Карло. Т.Б. Попова, Л.А. Бакалейников, М.В. Заморянская, Е.Ю. Флегонтова	6	686
Сэндвич-структура InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников. Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин	1	101			
Вклад оже-рекомбинации в насыщение ваттамперных характеристик мощных полупроводниковых лазеров ($\lambda = 1.0-1.9$ мкм). А.В. Лютецкий, К.С. Борщев, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов	1	106			

Изменение оптических свойств нанокластеров CdS, полученных методом Ленгмюра — Блоджетт, при пассивации в аммиаке. Е.А. Багаев, К.С. Журавлев, Л.Л. Свешникова, Д.В. Щеглов	6	718	Магнитофотолуминесценция в разделиненном гетеропереходе II типа $n\text{-GaInAsSb}/p\text{-InAs}$. К.Д. Моисеев, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев, К. Королев, С. Meinning, В. McCombe	9	1126
Энергетические характеристики экситонов в структурах на основе твердых растворов InGaN. С.О. Усов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин, А.В. Сахаров, Е.Е. Заварин, М.А. Синицын, Н.Н. Леденцов	6	736	Экситонные состояния и фотолуминесценция кремниевых и германиевых нанокристаллов в матрице Al_2O_3 . И.М. Купчак, Ю.В. Крюченко, Д.В. Корбутяк, А.В. Саченко, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Е.В. Бегун	10	1213
Формирование SiO_2 -слоев при плазменном распылении Si- и SiO_2 -мишеней. А.Н. Карпов, Д.В. Марин, В.А. Володин, J. Jedrzejewski, Г.А. Качурин, E. Savir, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая, Y. Goldstein, I. Balberg	6	747	Фотофизические свойства кремнийсодержащих полисилицилиденазометиннов. Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин	10	1233
Спектры фотолуминесценции гетероструктур $n\text{-ZnO}/p\text{-GaN}(\text{Er} + \text{Zn})$ и $p\text{-AlGaN}(\text{Er} + \text{Zn})$. М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Н.А. Феоктистов, Э.Ю. Даниловский, Р.В. Кузьмин, С.В. Разумов, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов	7	782	Влияние уровня возбуждения на оптические свойства микродиска $\text{GaAs}-\text{AlGaO}$ с активной областью на основе квантовых точек InAs. А.М. Надточий, С.А. Блохин, А.В. Сахаров, М.М. Кулагина, Ю.М. Задиранов, Н.Ю. Гордеев, М.В. Максимов, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов, Е. Шток, Т. Варминг, Д. Бимберг	10	1247
Нановключения InGaN в матрице AlGaN. В.С. Сизов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин	7	804	Магнитооптика одиночной квантовой ямы $\text{CdMnSe}/\text{CdMgSe}$. И.И. Решина, С.В. Иванов	11	1348
Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaAsN/InGaAsN на подложках GaAs. В.В. Мамутин, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, В.С. Михрин, А.М. Надточий, Е.В. Пирогов	7	823	Оптические свойства голубых светодиодов в системе InGaN/GaN при высокой плотности тока. Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Ю.С. Леликов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, А.С. Белов, Ю.Г. Шретер	11	1384
Изменение характеристик оксидных пленок гадолиния, титана и эрбия на поверхности $n\text{-}6\text{H-SiC}$ под воздействием сверхвысокочастотной обработки. Ю.Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, В.В. Миленин, О.Б. Охрименко, А.М. Светличный, В.В. Поляков	7	888	Субгергерцевые автоколебания в сверхбыстрой автомодуляции поглощения света в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневова, А.Н. Кривонососов	12	1426
Edge effects in propagation of terahertz radiation in subwavelength periodic structures. B. Gelmont, R. Parthasarathy, T. Globus	8	940	Квантово-размерные гетероструктуры на основе AlGaIn для светодиодов глубокого ультрафиолетового диапазона, полученные методом субмонослойной дискретной молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота. В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, Т.В. Шубина, А.В. Сахаров, А.А. Ситникова, П.С. Копьев, С.В. Иванов, Е.В. Луценко, А.В. Данильчик, Н.В. Ржеуцкий, Г.П. Яблонский	12	1452
Резонансное спиновое усиление в наноструктурах с анизотропной спиновой релаксацией и разбросом электронного g -фактора. М.М. Глазов, Е.Л. Ивченко	8	966	5.6.1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)		
Особенности оптической ориентации и релаксации электронных спинов в квантовых ямах с большим спиновым расщеплением. Н.С. Аверкиев, М.М. Глазов	8	973	Оптическая спектроскопия свободных экситонов в халькогенидном полупроводниковом соединении CuInS_2 . А.В. Мудрый, А.В. Иванюкович, М.В. Якушев, Р. Мартин, А. Саад	1	31
Цикличность сверхбыстрой автомодуляции спектра поглощения света, возникающей при накачке и стимулированном излучении в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневова, А.Н. Кривонососов, Т.А. Налет	9	1053	Вариация края поглощения света в пленках SiN_x с кластерами кремния. М.Д. Ефремов, В.А. Володин, Д.В. Марин, С.А. Аржанникова, Г.Н. Камаев, С.А. Кочубей, А.А. Попов	2	202
Барические свойства квантовых точек InAs. Б.В. Новиков, Г.Г. Зегря, Р.М. Пелешак, О.О. Данькин, В.А. Гайсин, В.Г. Талалаев, И.В. Штром, Г.Э. Цырлин	9	1094	Оптические параметры диодных лазеров на основе InAsSb/InAsSbP-гетероструктуры. А.П. Астахова, Т.В. Безьязычная, Л.И. Буров, А.С. Горбачевич, А.Г. Рябцев, Г.И. Рябцев, М.А. Щемелев, Ю.П. Яковлев	2	228
Электрофизические и структурные свойства двусторонне δ -легированных PHEMT-гетероструктур на основе AlGaAs/InGaAs/AlGaAs. И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов, В.Г. Мокеров, С.С. Широков, Р.М. Имамов, И.А. Субботин	9	1102	Исследование начальных стадий роста Mg на Si(111) при комнатной температуре методами оптической и электронной спектроскопии. К.Н. Галкин, С.А. Доценко, Н.Г. Галкин, М. Kumar, Govind, S.M. Shivaprasad	4	485
Краевая люминесценция наностержней ZnO при оптическом возбуждении большой мощности. А.Н. Грузинцев, А.Н. Редькин, Е.Е. Якимов, К. Бартоу (С. Barthou)	9	1110	Фундаментальные спектры оптических функций ферроэлектрика пиритрита натрия. В.В. Соболев, А.И. Калугин, В.Вал. Соболев, С.Г. Исхакова	7	777
Фотолуминесценция нанокластеров GeSi/Si, формирующихся в процессе сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в среде германа. Д.О. Филатов, М.В. Круглова, М.А. Исаков, С.В. Сипрова, М.О. Марычев, В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, С.А. Денисов	9	1116			

О пространственной симметрии возбужденных состояний в полупроводниках $A^{III}B^V$ в Г-точке. В.Д. Дымников, О.В. Константинов	8	934	Пространственное распределение дефектов и кинетика неравновесных носителей заряда в вюрцитных кристаллах GaN, легированных Sm, Eu, Er, Tm и дополнительно введенной примесью Zn. М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Ю.В. Кожанова	2	157
Исследование монокристаллов тройного соединения $CuIn_3Se_5$. И.В. Боднар	9	1046	Стимулированное излучение гетероструктур на основе $Cd_xHg_{1-x}Te$ при комнатной температуре в условиях оптической накачки. А.А. Андронов, Ю.Н. Ноздрин, А.В. Окомельков, А.А. Бабенко, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Р.Н. Смирнов	2	177
Магнитооптика одиночной квантовой ямы $CdMnSe/CdMgSe$. И.И. Решина, С.В. Иванов	11	1348	Фотолюминесценция локализованных экситонов в квантовых точках InGaN. С.О. Усов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин, А.В. Сахаров, Е.Е. Заварин, Н.Н. Леденцов	2	187
5.6.2. Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30)			Влияние водорода на анизотропию скорости роста p -GaN при газофазной эпитаксии из металлорганических соединений на стенках мезаполосков. В.В. Лундин, А.Е. Николаев, А.В. Сахаров, А.Ф. Цацульников	2	233
Особенности оптических и фотоэлектрических свойств специально не легированных и легированных Si монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук, Л.В. Булатецкая, А.Г. Кевшин	4	399	О способах испарения Si и легирующих примесей в методах вакуумной эпитаксии. В.П. Кузнецов, Н.А. Алябина, В.А. Боженкин, О.В. Белова, М.В. Кузнецов	3	257
Релаксация возбужденных состояний доноров в кремнии с излучением междолинных фононов. В.В. Цыпленков, Е.В. Демидов, К.А. Ковалевский, В.Н. Шастин	9	1032	Влияние примеси йода на релаксацию фотовозбужденного хлорида серебра. Ю.В. Вострикова, В.Г. Ключев	3	277
Цикличность сверхбыстрой автомодуляции спектра поглощения света, возникающей при накачке и стимулированном излучении в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневова, А.Н. Кривоносос, Т.А. Налет	9	1053	Влияние ультразвуковой обработки на фотоэлектрические и люминесцентные свойства кристаллов ZnSe. Е.М. Зобов, М.Е. Зобов, Ф.С. Габиров, И.К. Камилов, Ф.И. Манягин, Е.К. Наими	3	282
Инфракрасные спектры отражения многослойных эпитаксиальных гетероструктур с погруженными слоями InAs и GaAs. П.В. Середин, Э.П. Домашевская, А.Н. Лукин, И.Н. Арсентьев, Д.А. Винокуров, И.С. Тарасов	9	1072	Сравнительный анализ фото- и электролюминесценции многослойных структур с самоформирующимися островками Ge(Si)/Si(001). Ю.Н. Дроздов, З.Ф. Красильник, К.Е. Кудрявцев, Д.Н. Лобанов, А.В. Новиков, М.В. Шалеев, Д.В. Шенгуров, В.Б. Шагин, А.Н. Яблонский	3	291
Колебательная спектроскопия аморфного углерода, модифицированного Pt. В.И. Иванов-Омский, Т.К. Звонарева, Г.С. Фролова	9	1131	Фотолюминесценция с длиной волны до 1.6 мкм в квантовых точках с увеличенной эффективной толщиной слоя InAs. М.Н. Дроздов, Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.И. Шашкин	3	303
Фотофизические свойства кремнийсодержащих полисалицилиденазометинов. Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин	10	1233	Поляризационная пьезоспектроскопия фотолюминесценции квантовой ямы $GaAs/Al_{0.35}Ga_{0.65}As$:Ve. Н.С. Аверкиев, Ю.Л. Иванов, А.А. Красивичев, П.В. Петров, Н.И. Саблина, В.Е. Седов	3	322
Субгергерцовые автоколебания в сверхбыстрой автомодуляции поглощения света в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневова, А.Н. Кривоносос	12	1426	Фотолюминесценция полупроводниковых структур на основе бутилзамещенных фталоцианинов эрбия. И.А. Белогорохов, Ю.В. Рябчиков, Е.В. Тихонов, В.Е. Пушкарев, М.О. Бреусова, Л.Г. Томилова, Д.Р. Хохлов	3	327
5.6.3. Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)			Кремниевые светодиоды с большой мощностью излучения краевой люминесценции. А.М. Емельянов, Н.А. Соболев	3	336
Оптическая спектроскопия свободных экситонов в халькопиритном полупроводниковом соединении $CuInS_2$. А.В. Мудрый, А.В. Иванович, М.В. Якушев, Р. Мартин, А. Саад	1	31	Люминесцентные свойства светодиодов на основе арсенида галлия с антистоксовым люминофором $Y_2O_3S:Er,Yb$. А.Н. Грузинцев, К. Бартоху, П. Беналул	3	365
Эмиссия горячих электронов, возбужденных в ходе каталитической реакции, из металла в полупроводник. В.Ф. Харламов, А.В. Костин, М.В. Кубышкина, Ф.В. Харламов	1	60	Особенности оптических и фотоэлектрических свойств специально не легированных и легированных Si монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук, Л.В. Булатецкая, А.Г. Кевшин	4	399
Каналы излучательной рекомбинации в $Si/Si_{1-x}Ge_x$ -наноструктурах. Ю.А. Берашевич, А.С. Панфиленко, В.Е. Борисенко	1	68			
Сэндвич-структура InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников. Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин	1	101			
Электрофизические свойства слоев $Si:Er/Si$, выращенных методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии. О.В. Белова, В.Н. Шабанов, А.П. Касаткин, О.А. Кузнецов, А.Н. Яблонский, М.В. Кузнецов, В.П. Кузнецов, А.В. Корнаухов, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник	2	136			

Спектры излучения гетероструктур с квантовыми ямами типа InGaN/AlGaN/GaN: модель двумерной комбинированной плотности состояний. М.Л. Бадгудинов, А.Э. Юнович	4	438	Энергетические характеристики экситонов в структурах на основе твердых растворов InGaN. С.О. Усов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин, А.В. Сахаров, Е.Е. Заварин, М.А. Синицын, Н.Н. Леденцов	6	736
Исследование начальных стадий роста Mg на Si(111) при комнатной температуре методами оптической и электронной спектроскопии. К.Н. Галкин, С.А. Доценко, Н.Г. Галкин, М. Kumar, Govind, S.M. Shivaprasad	4	485	Формирование SiO _x -слоев при плазменном распылении Si- и SiO ₂ -мишеней. А.Н. Карпов, Д.В. Марин, В.А. Володин, J. Jędrzejewski, Г.А. Качурин, E. Savir, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая, Y. Goldstein, I. Balberg	6	747
Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллических соединений AgCd ₂ GaS ₄ . Л.В. Булатецкая, В.В. Божко, Г.Е. Давидок, О.В. Парасюк	5	522	Концентрация и температура носителей заряда в квантовых ямах лазерных гетероструктур в режимах спонтанного и стимулированного излучения. Л.Е. Воробьев, В.Л. Зерова, К.С. Борщев, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов, G. Belenky	6	753
Электролюминесценция и фототриггерный эффект в монокристаллах твердых растворов GaS _x Se _{1-x} . А.Г. Кязым-заде, В.М. Салманов, А.Г. Мохтари, В.В. Дадашова, А.А. Агаева	5	532	Спектры фотолюминесценции гетероструктур n-ZnO/p-GaN(Er + Zn) и p-AlGaN(Er + Zn). М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Н.А. Феоктистов, Э.Ю. Даниловский, Р.В. Кузьмин, С.В. Разумов, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов	7	782
У- и Z-люминесценция поликристаллического теллурида кадмия, полученного неравновесной реакцией прямого синтеза компонентов. В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков	5	536	Наповключения InGaN в матрице AlGaN. В.С. Сизов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин	7	804
Особенности спектров собственной фотопроводимости в фосфиде индия, компенсированном медью. Ф.В. Макаренко, Н.Н. Прибылов, С.И. Рембеза, В.А. Мельник	5	542	Периодическое создание кратковременной инверсии населенностей на межподзонных лазерных переходах в квантовых ямах. В.А. Кукушкин	7	810
Резонансное тунелирование носителей в фотовозбужденных гетероструктурах 2-го типа ZnSe/BeTe. С.В. Зайцев, А.А. Максимов, И.И. Тартаковский, Д.Р. Яковлев, А. Ваг	5	555	Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaAsN/InGaAsN на подложках GaAs. В.В. Мамутин, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, В.С. Михрин, А.М. Надточий, Е.В. Пирогов	7	823
Инфракрасные спектры пропускания фотолюминесцентных пленок оксидов с Si-, Ge-квантовыми точками, сформированных импульсным лазерным осаждением. И.П. Лисовский, С.А. Злобин, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Е.В. Бегун	5	560	Управление заселенностью верхней рабочей подзоны электрическим полем в структурах с асимметричными барьерами для униполярного лазера. Ю.А. Алещенко, А.Е. Жуков, В.В. Капаев, Ю.В. Копаев, П.С. Копьев, В.М. Устинов	7	856
Теоретическое исследование процессов ожереккомбинации в глубоких квантовых ямах. Л.В. Данилов, Г.Г. Зегря	5	566	Состав и параметры доменов, образующихся в результате спинодального распада четверных твердых растворов в эпитаксиальных гетероструктурах GaInP/Ga _{1-x} In _{1-x} As _y P _{1-y} /GaInP/GaAs(001). Э.П. Домашевская, Н.Н. Гордиенко, Н.А. Румянцева, П.В. Середин, Б.Л. Агапов, Л.А. Битюцкая, И.Н. Арсентьев, Л.С. Вавилова, И.С. Тарасов	9	1086
Пороговые характеристики ИК-лазера на основе глубоких квантовых ям InAsSb/AlSb. Л.В. Данилов, Г.Г. Зегря	5	573	Барические свойства квантовых точек InAs. Б.В. Новиков, Г.Г. Зегря, Р.М. Пелешак, О.О. Данькив, В.А. Гайсин, В.Г. Талалаев, И.В. Штрот, Г.Э. Цырлин	9	1094
Усиление фотолюминесценции структур с нанокристаллическим кремнием, стимулированное низкодозовым γ-облучением. И.П. Лисовский, И.З. Индутный, М.В. Муравская, В.В. Войтович, Е.Г. Гуле, П.Е. Шепелявый	5	591	Краевая люминесценция наностержней ZnO при оптическом возбуждении большой мощности. А.Н. Грузинцев, А.Н. Редькин, Е.Е. Якимов, К. Бартоу (C. Barthou)	9	1110
Собственная люминесценция Tb в металл-полимерных комплексах полиамидокислот. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, Д.М. Жигунов, И.В. Подешво, С.Е. Никитин, П.А. Форш, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский	5	618	Магнитофотолюминесценция в разьединенном гетеропереходе II типа n-GaInAsSb/p-InAs. К.Д. Моисеев, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев, К. Королев, С. Mcinning, В. McCombe	9	1126
Источники спонтанного излучения на основе арсенида индия. Н.В. Зотова, Н.Д. Ильинская, С.А. Карандашёв, Б.А. Матвеев, М.А. Реманный, Н.М. Стусь	6	641	Влияние интенсивности торможения ионов на дефектообразование при имплантации в нанокристаллы кремния. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, Д.В. Марин, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, В.А. Володин	9	1145
Релаксация параметров тонкопленочных электролюминесцентных структур на основе ZnS:Mn при выключении. Н.Т. Гурин, О.Ю. Сабитов	6	692	Исследование свойств эпитаксиального и слиткового антимонида галлия. В.П. Хвостиков, С.В. Сорокина, Н.С. Потапович, О.А. Хвостикова, А.С. Власов, Е.П. Ракова, В.М. Андреев	10	1198
Изменение оптических свойств нанокластеров CdS, полученных методом Ленгмюра—Блуджетт, при пассивации в аммиаке. Е.А. Багаев, К.С. Журавлев, Л.Л. Свешникова, Д.В. Щеглов	6	718	Экситонные состояния и фотолюминесценция кремниевых и германиевых нанокристаллов в матрице Al ₂ O ₃ . И.М. Купчак, Ю.В. Крюченко, Д.В. Корбутяк, А.В. Саченко, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Е.В. Бегун	10	1213
Формирование сверхизлучения в наногетероструктурах с квантовыми точками. А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря	6	730			

Фотофизические свойства кремнийсодержащих полисалицилиденазометинов. Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин	10	1233
Особенности влияния электроннои и нейтронной радиации на фотоэлектрические свойства специально не легированных и легированных Си монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л.В. Булатецкая	10	1263
Влияние электрического поля при получении пленок $\alpha\text{-SiO}_2 : \text{H}\langle\text{Er}, \text{O}\rangle$ методом магнетронного распыления на постоянном токе на их состав и интенсивность фотолюминесценции ионов эрбия. Ю.К. Ундалов, Е.И. Теруков, О.Б. Гусев, В.М. Лебедев	11	1357
Светочувствительные свойства металлосодержащих полидисалицилиденазометинов. Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин	11	1367
Измерение коэффициента поглощения света, распространяющегося латерально в светодиодных структурах с квантовыми ямами $\text{In}_{0,2}\text{Ga}_{0,8}\text{N}/\text{GaN}$. Ю.С. Леликов, Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, Д.В. Тархин, Ю.Г. Шретер	11	1371
Краевая электролюминесценция эффективного точечного кремниевого светодиода в области температур 80–300 К. А.М. Емельянов	11	1375
Оптические свойства голубых светодиодов в системе InGaN/GaN при высокой плотности тока. Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Ю.С. Леликов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, А.С. Белов, Ю.Г. Шретер	11	1384
5.6.4. Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т.п.) (PACS 78.66)		
Роль фоновых примесей О и Си в оптике кристаллов ZnSe с позиций теории непересекающихся зон. Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, Е.М. Гавришук, В.Г. Галстян	2	131
Стимулированное излучение гетероструктур на основе $\text{Cd}_z\text{Hg}_{1-z}\text{Te}$ при комнатной температуре в условиях оптической накачки. А.А. Андронов, Ю.Н. Ноздрин, А.В. Окомельков, А.А. Бабенко, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Р.Н. Смирнов	2	177
Эффективная генерация нервой волиноводной моды в гетеролазере $\text{InGaAs}/\text{GaAs}/\text{InGaP}$. А.А. Бирюков, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин, В.Я. Алёшкин, А.А. Дубинов, В.В. Кочаровский, Вл.В. Кочаровский	3	361
Влияние условий осаждения и отжига пленок легированного фтором оксида индия (IFO) на фотоэлектрические свойства гетероперехода $\text{IFO}/p\text{-Si}$. Г.Г. Унтила, Т.Н. Кост, А.Б. Чеботарева, М.Б. Закс, А.М. Ситников, О.И. Солодуха	4	415
Свойства пленок оксида цинка, синтезированных в низкотемпературном плазменном разряде в условиях бомбардировки компонентами плазмы. А.А. Сердобинцев, А.Г. Веселов, О.А. Кирясова	4	496

Особенности спектров собственной фотопроводимости в фосфиде индия, компенсированном медью. Ф.В. Макаренко, Н.Н. Прибылов, С.И. Рембеза, В.А. Мельник	5	542
Собственная люминесценция Тв в металл-полимерных комплексах полиамидокислот. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, Д.М. Жигунов, И.В. Подешво, С.Е. Никитин, П.А. Форш, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский	5	618
О волновых функциях горячих экситонов в полупроводниках с вырожденными зонами. А.В. Ефанов	6	658
Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. I. Теория, оптические свойства материалов. Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов	7	864
Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. II. Анализ гетероструктур на различных подложках. Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов	7	871
Резонансное спиновое усиление в наноструктурах с анизотропной спиновой релаксацией и разбросом электронного g -фактора. М.М. Глазов, Е.Л. Ивченко	8	966
Особенности спектров люминесценции кристаллов $\text{ZnS}(\text{O})$ и $\text{ZnS}\cdot\text{Cu}(\text{O})$ с позиций теории непересекающихся зон. Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, В.Г. Галстян, Е.М. Гавришук	9	1039
Инфракрасные спектры отражения многослойных эпитаксиальных гетероструктур с погруженными слоями InAs и GaAs . П.В. Середин, Э.П. Домашевская, А.Н. Лукин, И.Н. Арсентьев, Д.А. Винокуров, И.С. Тарасов	9	1072
Фотолюминесценция нанокластеров GeSi/Si , формирующихся в процессе сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в среде германа. Д.О. Филатов, М.В. Круглова, М.А. Исаков, С.В. Сипрова, М.О. Марычев, В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, С.А. Денисов	9	1116
Фотофизические свойства кремнийсодержащих полисалицилиденазометинов. Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин	10	1233
Свойства и структура стекол $(\text{As}_2\text{Se}_3)_{1-z}(\text{SnSe}_2)_{z-x}(\text{Te}_2\text{Se})_x$ и $(\text{As}_2\text{Se}_3)_{1-z}(\text{SnSe})_{z-x}(\text{Te}_2\text{Se})_x$. Г.А. Бордовский, А.В. Марченко, Е.И. Теруков, П.П. Серегин, Т.В. Лиходеева	11	1353
Светочувствительные свойства металлосодержащих полидисалицилиденазометинов. Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин	11	1367
Измерение коэффициента поглощения света, распространяющегося латерально в светодиодных структурах с квантовыми ямами $\text{In}_{0,2}\text{Ga}_{0,8}\text{N}/\text{GaN}$. Ю.С. Леликов, Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, Д.В. Тархин, Ю.Г. Шретер	11	1371
5.7. Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79)		
Действие мощных нано- и фемтосекундных лазерных импульсов на кремниевые наноструктуры. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, В.А. Володин, Д.В. Марин, М. Deutschmann	2	181

Малощумящие фотодиоды на основе двойной гетероструктуры GaSb/GaInAsSb/AlGaAsSb для спектрального диапазона 1—4.8 мкм. Б.Е. Журтанов, Н.Д. Ильинская, А.Н. Именков, М.П. Михайлова, К.В. Калинина, М.А. Сиповская, Н.Д. Стоянов, Ю.П. Яковлев	4	468
Высоочастотные свойства двухъямных наноструктур. В.Ф. Елесин, И.Ю. Катеев	5	586
Рентгеноспектральный микроанализ полупроводниковых эпитаксиальных гетероструктур на основе моделирования транспорта электронов методом Монте-Карло. Т.Б. Попова, Л.А. Бакалейников, М.В. Заморянская, Е.Ю. Флегонтова	6	686

6. Физика полупроводниковых приборов (PACS 84; 85)

Линейная стадия эволюции электронно-дырочных лавин в полупроводниках. А.С. Кюрегян	1	23
Расщепление пика натрия на динамических вольтамперных характеристиках конвективных ионных токов структур металл-окисел-полупроводник. С.Г. Дмитриев, Ю.В. Маркин	1	45
Высокотемпературные матрицы детекторов ядерного излучения на основе 4H-SiC ионно-легированных $p^+ - n$ -переходов. Е.В. Калинина, Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, А.А. Ситникова, А.В. Садохин, А.Ю. Азаров, В.Г. Коссов, Р.Р. Яфаев	1	87
Восстановление профиля потенциала в изолирующем слое по вольтамперным характеристикам туннельных МДП диодов. Е.И. Гольдман, А.Г. Ждан, Н.Ф. Кухарская, М.В. Черняев	1	94
Сэндвич-структура InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников. Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин	1	101
Вклад оже-рекомбинации в насыщение ваттамперных характеристик мощных полупроводниковых лазеров ($\lambda = 1.0 - 1.9$ мкм). А.В. Лютецкий, К.С. Борщёв, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов	1	106
Инжекционные фотоприемники. И.М. Викулин, Ш.Д. Курмашев, В.И. Стафеев	1	113
Электрофизические свойства слоев Si:Er/Si, выращенных методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии. О.В. Белова, В.Н. Шабанов, А.П. Касаткин, О.А. Кузнецов, А.Н. Яблонский, М.В. Кузнецов, В.П. Кузнецов, А.В. Корнаухов, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник	2	136
Влияние оже-рекомбинации на тепловую стабильность мощных высоковольтных полупроводниковых диодов. Т.Т. Мнацаканов, М.Е. Левинштейн, А.С. Фрейдлин	2	220
Влияние водорода на анизотропию скорости роста p -GaN при газофазной эпитаксии из металлорганических соединений на стенках мезаполосков. В.В. Лундин, А.Е. Николаев, А.В. Сахаров, А.Ф. Цацульников	2	233
О способах иснарения Si и легирующих примесей в методах вакуумной эпитаксии. В.П. Кузнецов, Н.А. Алябина, В.А. Боженкин, О.В. Белова, М.В. Кузнецов	3	257

Моделирование приповерхностной протонно-стимулированной диффузии бора в кремнии. О.В. Александров, В.В. Козловский	3	262
Механизмы выпрямления высокочастотного сигнала полевым гетеротранзистором с коротким каналом. М.Л. Орлов	3	346
Electrical properties of InP/InGaAs pn heterostructure-emitter bipolar transistor. Jung-Hui Tsai, Wen-Chau Liu, Der-Feng Guo, Yu-Chi Kang, Shao-Yen Chiu, Wen-Shiung Lour	3	353
Люминоцентные свойства светодиодов на основе арсенида галлия с антистоксовым люминофором $Y_2O_3:Er,Yb$. А.Н. Грузинцев, К. Бартхоу, П. Беналул	3	365
Влияние условий осаждения и отжига пленок легированного фтором оксида индия (IFO) на фотоэлектрические свойства гетероперехода IFO/ p -Si. Г.Г. Унтила, Т.Н. Кост, А.Б. Чеботарева, М.Б. Закс, А.М. Ситников, О.И. Солодуха	4	415
Спектры излучения гетероструктур с квантовыми ямами типа InGaN/AlGaIn/GaN: модель двумерной комбинированной плотности состояний. М.Л. Бадгутдинов, А.Э. Юнович	4	438
Динамика формирования фотоответа в детекторной структуре из арсенида галлия. Г.И. Айзенштат, М.А. Лелеков, О.П. Толбанов	4	451
Разработка фотоприемников для преобразователей изображений: легирование кремния селеном из газовой фазы. Ю.А. Астров, В.Б. Шуман, А.Н. Лодыгин, Л.М. Порцель, А.Н. Махова	4	457
Термостойкий диод Шоттки $TiV_x - n$ -GaP. А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, А.Б. Камалов, Л.М. Капитанчук, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, М.У. Насыров	4	463
Малощумящие фотодиоды на основе двойной гетероструктуры GaSb/GaInAsSb/AlGaAsSb для спектрального диапазона 1—4.8 мкм. Б.Е. Журтанов, Н.Д. Ильинская, А.Н. Именков, М.П. Михайлова, К.В. Калинина, М.А. Сиповская, Н.Д. Стоянов, Ю.П. Яковлев	4	468
Нелинейно-оптическое преобразование частоты в двухцветном лазере с вертикальным внешним резонатором. Ю.А. Морозов, И.С. Нефедов, Т. Leinonen, М.Ю. Морозов	4	473
Электролюминесценция и фототриггерный эффект в монокристаллах твердых растворов GaS_xSe_{1-x} . А.Г. Кязым-заде, В.М. Салманов, А.Г. Мохтари, В.В. Дашаева, А.А. Агаева	5	532
Источники спонтанного излучения на основе арсенида индия. Н.В. Зотова, Н.Д. Ильинская, С.А. Карандашёв, Б.А. Матвеев, М.А. Ременный, Н.М. Стусь	6	641
Электронные характеристики однократно ионизированной пары доноров фосфора в кремнии и операции с зарядовыми кубитами. А.Н. Воронько	6	672
О воздействии оптического излучения на чувствительность газовых сенсоров на основе пленок SnO_2-x . А.М. Гуляев, Ле Ван Ван, О.Б. Сарач, О.Б. Мухина	6	742
Концентрация и температура носителей заряда в квантовых ямах лазерных гетероструктур в режимах спонтанного и стимулированного излучения. Л.Е. Воробьев, В.Л. Зерова, К.С. Борщёв, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов, G. Belenky	6	753

Свойства барьерных контактов к InP с наноразмерными слоями TiV _x . И.Н. Арсентьев, А.В. Бобыль, И.С. Тарасов, Н.С. Болтовцев, В.Н. Иванов, А.Е. Беляев, А.Б. Камалов, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, Е.В. Руссу	7	793
Нановключения InGaN в матрице AlGaN. В.С. Сизов, А.Ф. Цацудьников, В.В. Лундин	7	804
Measurement and comparison of silicon p-i-n photodiodes as impedance at different voltages. S. Özden, H. Bayhan, A. Dönmez, M. Bayhan	7	852
Boundary instability of a two-dimensional electron fluid. M.I. Dyakonov	8	998
Сравнительный анализ предельной эффективности фотопреобразования обычных солнечных элементов и солнечных элементов с квантовыми ямами. А.В. Саченко, И.О. Соколовский	10	1238
Влияние уровня возбуждения на оптические свойства микродиска GaAs-AlGaO с активной областью на основе квантовых точек InAs. А.М. Надточий, С.А. Блохин, А.В. Сахаров, М.М. Кулагина, Ю.М. Задиранов, Н.Ю. Гордеев, М.В. Максимов, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов, Е. Шток, Т. Варминг, Д. Бимберг	10	1247
Каталитические свойства композитных слоев аморфный углерод-платина в топливных элементах. А.А. Нечитайлов, Т.К. Звонарева, А.Д. Ременюк, В.А. Толмачев, Д.Н. Горячев, О.С. Ельцина, Л.В. Беляков, О.М. Сресели	10	1268
Образование омических контактов к пизкоомному Cd _{1-x} Mg _x Te для фотовольтаических применений. О.А. Парфенюк, М.И. Илашук, К.С. Ульяницкий	11	1314
Особенности световых вольт-амперных характеристик p-i-n-структур на аморфном кремнии при туннельно-дрейфовом механизме переноса теплового тока. А.А. Андреев	11	1363
Измерение коэффициента поглощения света, распространяющегося латерально в светодиодных структурах с квантовыми ямами In _{0.2} Ga _{0.8} N/GaN. Ю.С. Леликов, Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, Д.В. Тархин, Ю.Г. Шретер	11	1371
Краевая электролюминесценция эффективного точечного кремниевого светодиода в области температур 80–300 К. А.М. Емельянов	11	1375
Особенности вольт-фарадных характеристик МОП структур, обусловленные зарядом в окисле. Е.А. Боброва, Н.М. Омеляновская	11	1380
Оптические свойства голубых светодиодов в системе InGaN/GaN при высокой плотности тока. Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Ю.С. Леликов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, А.С. Белов, Ю.Г. Шретер	11	1384
Квантово-размерные гетероструктуры на основе AlGaIn для светодиодов глубокого ультрафиолетового диапазона, полученные методом субмоплойной дискретной молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота. В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, Т.В. Шубина, А.В. Сахаров, А.А. Ситникова, П.С. Копьев, С.В. Иванов, Е.В. Луценко, А.В. Данильчик, Н.В. Ржеуцкий, Г.П. Яблонский	12	1452

Эффективный полупроводниковый лазер зеленого диапазона с электронноуправляемой пакачкой на основе многослойных наноструктур A ^{III} B ^{VI} . М.М. Зверев, Н.А. Гамов, Е.В. Жданова, Д.В. Перегудов, В.Б. Студенов, И.В. Седова, С.В. Гронин, С.В. Сорокин, С.В. Иванов, П.С. Копьев	12	1472
Рост слитков карбида кремния полнотипа 4H на затравках с плоскостью (10 $\bar{1}$ 0). Д.Д. Авров, А.В. Булатов, С.И. Дорожкин, А.О. Лебедев, Ю.М. Таиров	12	1483

7. Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур (PACS 81; 85)

Возможности и основные принципы управления пластической релаксацией пленок GeSi/Si и Ge/Si ступенчато изменяемого состава. Ю.Б. Болховитянов, А.К. Гутаковский, А.С. Дерябин, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов	1	3
Эмиссия горячих электронов, возбужденных в ходе каталитической реакции, из металла в полупроводник. В.Ф. Харламов, А.В. Костин, М.В. Кубышкина, Ф.В. Харламов	1	60
In situ исследование кинетики формирования КТ InSb в матрице InAs(Sb). А.Н. Семенов, О.Г. Люблинская, В.А. Соловьев, Б.Я. Мельцер, С.В. Иванов	1	75
Сэндвич-структура InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников. Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин	1	101
Оптические свойства твердых растворов AgGa _x In _{1-x} Se ₂ . И.В. Боднар	2	153
Действие мощных пико- и фемтосекундных лазерных импульсов на кремниевые наноструктуры. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, В.А. Володин, Д.В. Марин, М. Deutschmann	2	181
Вариация края поглощения света в пленках SiN _x с кластерами кремния. М.Д. Ефремов, В.А. Володин, Д.В. Марин, С.А. Аржанникова, Г.Н. Камаев, С.А. Кочубей, А.А. Попов	2	202
Влияние водорода на анизотропию скорости роста p-GaN при газофазной эпитаксии из металлорганических соединений на стенках мезополосков. В.В. Лундин, А.Е. Николаев, А.В. Сахаров, А.Ф. Цацудьников	2	233
Диффузия хрома в эпитаксиальный арсенид галлия. М.Д. Вилисова, Е.П. Другова, И.В. Пономарев, В.А. Чубирко	2	239
Фотолуминесценция с длиной волны до 1.6 мкм в квантовых точках с увеличенной эффективной толщиной слоя InAs. М.Н. Дроздов, Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.И. Шашкин	3	303
Механизм формирования отклика газового сенсора водорода на основе кремниевого МОП диода. В.И. Гаман, В.И. Балюба, В.Ю. Грицык, Т.А. Давыдова, В.М. Калыгина	3	341

Собственный окисел, возникающий на поверхности скола селенида галлия в результате длительного хранения. С.И. Драпак, С.В. Гаврилюк, З.Д. Ковалюк, О.С. Литвин	4	423	Электрохимическое травление макропор в кремнии с щелевыми затравками. Е.В. Астрова, А.А. Нечитайлов	6	762
Динамика формирования фотоответа в детекторной структуре из арсенида галлия. Г.И. Айзенштат, М.А. Лелеков, О.П. Толбанов	4	451	Свойства барьерных контактов к InP с наноразмерными слоями TiB ₂ . И.Н. Арсентьев, А.В. Бобыль, И.С. Тарасов, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, А.Е. Беляев, А.Б. Камалов, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, Е.В. Руссу	7	793
Термостойкий диод Шоттки TiB ₂ —p-GaP. А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, А.Б. Камалов, Л.М. Капитанчук, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, М.У. Насыров	4	463	Изменение характеристик оксидных пленок гадолиния, титана и эрбия на поверхности n-6H-SiC под воздействием сверхвысокочастотной обработки. Ю.Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, В.В. Миленин, О.Б. Охрименко, А.М. Светличный, В.В. Поляков	7	888
Краевой эффект при электрохимическом травлении кремния. Е.В. Астрова, А.А. Нечитайлов	4	480	Процессы возбуждения ионов Er ³⁺ в SiO ₂ с нанокристаллами Si. А.А. Прокофьев, А.С. Москаленко, И.Н. Ясневич	8	985
Свойства пленок оксида цинка, синтезированных в низкотемпературном плазменном разряде в условиях бомбардировки компонентами плазмы. А.А. Сердобинцев, А.Г. Веселов, О.А. Кирясова	4	496	Релаксация возбужденных состояний допоров в кремнии с излучением междолинных фононов. В.В. Цыпленков, Е.В. Демидов, К.А. Ковалевский, В.Н. Шагин	9	1032
Сравнительный анализ механизмов формирования межфазной границы пленочной структуры в равновесных и резко неравновесных условиях. А.П. Беляев, В.П. Рубец, В.В. Антипов, Х.А. Тошходжаев	5	519	Адсорбция метилтиола на поверхности GaAs(100)-(2 × 4): квантово-химический анализ из первых принципов. М.В. Лебедев	9	1065
Примесная проводимость монокристаллов Hg ₂ In ₂ Te ₆ . Л.А. Косяченко, И.И. Герман, И.М. Раренко, З.И. Захарук, Е.С. Никонюк	5	528	Состав и параметры доменов, образующихся в результате спинодального распада четверных твердых растворов в эпитаксиальных гетероструктурах GaInP/Ga _x In _{1-x} As _y P _{1-y} /GaInP/GaAs(001). Э.П. Домашевская, Н.Н. Гордисенко, Н.А. Румянцева, П.В. Середин, Б.Л. Агапов, Л.А. Битюцкая, И.Н. Арсентьев, Л.С. Вавилова, И.С. Тарасов	9	1086
Особенности спектров собственной фотопроводимости в фосфиде индия, компенсированном медью. Ф.В. Макаренко, Н.Н. Прибылов, С.И. Рембеза, В.А. Мельник	5	542	Барические свойства квантовых точек InAs. Б.В. Новиков, Г.Г. Зегря, Р.М. Пелешак, О.О. Данькив, В.А. Гайсин, В.Г. Талалаев, И.В. Штром, Г.Э. Цырлин	9	1094
Критическая толщина перехода по Странскому—Крастанову с учетом эффекта сегрегации. Д.В. Юрасов, Ю.Н. Дроздов	5	579	Фотолюминесценция нанокластеров GeSi/Si, формирующихся в процессе сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в среде германа. Д.О. Филатов, М.В. Круглова, М.А. Исаков, С.В. Сипрова, М.О. Марычев, В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, С.А. Денисов	9	1116
Термическая неустойчивость фуллеренов кремния, стабилизируемых водородом. Компьютерный эксперимент. А.Е. Галашев	5	611	Диффузия имплантированного натрия в кислородном кремнии. В.М. Король, С.А. Веденяпин, А.В. Заставной, V. Ovchinnikov	9	1140
Особенности пространственного распределения In в эпитаксиальных слоях InGaN, выращенных молекулярно-пучковой эпитаксией с плазменной активацией. В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, Т.В. Шубина, Д.С. Плотников, М.В. Заморянская, М.А. Ягвокина, Я.В. Домрачева, А.А. Ситникова, С.В. Иванов	5	630	Число Лоренца и фактор Холла в вырожденных полупроводниках при резонансном рассеянии носителей тока. Л.В. Прокофьева, А.А. Шабалдин, В.А. Корчагин, С.А. Немов, Ю.И. Равич	10	1180
Исследование зависимости электрофизических параметров пленок Cd _x Hg _{1-x} Te, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, от уровня легирования индием. В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Д.Г. Икусов, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, Г.Ю. Сидоров, М.В. Якушев	6	664	Исследование свойств эпитаксиального и слиткового антимонида галлия. В.П. Хвостиков, С.В. Сорочкина, Н.С. Потапович, О.А. Хвостикова, А.С. Власов, Е.П. Ракова, В.М. Андреев	10	1198
Исследование влияния температуры крекинга мышьяка на эффективность его встраивания в пленки CdHgTe в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии. Г.Ю. Сидоров, Н.Н. Михайлов, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Ю.Г. Сидоров, С.А. Дворецкий	6	668	Экситонные состояния и фотолюминесценция кремниевых и германиевых нанокристаллов в матрице Al ₂ O ₃ . И.М. Купчак, Ю.В. Крюченко, Д.В. Корбутяк, А.В. Саченко, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Е.В. Бегун	10	1213
Изменение оптических свойств нанокластеров CdS, полученных методом Ленгмюра—Блоджетт, при насыщении в аммиаке. Е.А. Багаев, К.С. Журавлев, Л.Л. Свешникова, Д.В. Щеглов	6	718	Особенности влияния электронной и нейтронной радиации на фотоэлектрические свойства специально легированных и легированных Si монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л.В. Булатецкая	10	1263
Латеральное упорядочение нановискеров GaAs на поверхностях GaAs(111)В и GaAs(110) при молекулярно-пучковой эпитаксии. Г.Э. Цырлин, Н.В. Сибирев, С. Sartel, J.-C. Harmand	6	726	Каталитические свойства композитных слоев аморфный углерод—платина в топливных элементах. А.А. Нечитайлов, Т.К. Звонарева, А.Д. Ременюк, В.А. Толмачев, Д.Н. Горячев, О.С. Ельцина, Л.В. Беляков, О.М. Сресели	10	1268
Формирование SiO ₂ -слоев при плазменном распылении Si- и SiO ₂ -мишеней. А.Н. Карпов, Д.В. Марин, В.А. Володин, J. Jedrzejewski, Г.А. Качурин, E. Savič, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая, Y. Goldstein, I. Balberg	6	747			

- Образование омических контактов к низкоомному $\text{Cd}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Te}$ для фотовольтаических применений.** О.А. Парфенюк, М.И. Илащук, К.С. Ульяницкий . . 11 1314
- Статические вольт-амперные характеристики туннельных МДП структур $\text{Au}/\text{CaF}_2/n\text{-Si}(111)$.** С.М. Сутурин, А.Г. Банщиков, Н.С. Соколов, С.Э. Тягинов, М.И. Векслер 11 1333
- Влияние электрического поля при получении пленок $\alpha\text{-SiO}_x:\text{H}(\text{Er},\text{O})$ методом магнетронного распыления на постоянном токе на их состав и интенсивность фотолюминесценции ионов эрбия.** Ю.К. Ундалов, Е.И. Теруков, О.Б. Гусев, В.М. Лебедев 11 1357
- Особенности вольт-фарадных характеристик МОП структур, обусловленные зарядом в окисле.** Е.А. Боброва, Н.М. Омеляновская 11 1380
- Модель термического окисления кремния на фронте объемной реакции.** О.В. Александров, А.И. Дусь . . 11 1400
- Исследование промежуточного слоя на гетерогранице $n^+\text{-CdS}/p\text{-CdTe}$.** С.А. Музафарова, Б.У. Айтбаев, Ш.А. Мирсагатов, К. Дуршимбетов, Ж. Жанабергенов 12 1409
- Квантово-размерные гетероструктуры на основе AlGaIn для светодиодов глубокого ультрафиолетового диапазона, полученные методом субмонослойной дискретной молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота.** В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, Т.В. Шубина, А.В. Сахаров, А.А. Ситникова, П.С. Копьев, С.В. Иванов, Е.В. Луценко, А.В. Данильчик, Н.В. Ржеуцкий, Г.П. Яблонский 12 1452
- Эффективный полупроводниковый лазер зеленого диапазона с электроннолучевой накачкой на основе многослойных наноструктур $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$.** М.М. Зверев, Н.А. Гамов, Е.В. Жданова, Д.В. Перегудов, В.Б. Студенов, И.В. Седова, С.В. Гронин, С.В. Сорокин, С.В. Иванов, П.С. Копьев 12 1472
- Особенности формирования нитевидных нанокристаллов GaAs на различных поверхностях кремния при молекулярно-пучковой эпитаксии.** Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, В.П. Улин, В.Г. Дубровский 12 1478